#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# . I TERTE BANJOTET I BURNE KIRN BERN BERN EINE FOR FOR HERN BERN BERN BORGE FOR BERN BERDEN KERD HAR HERN

## (43) 国際公開日 2004 年11 月18 日 (18.11.2004)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2004/100249 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/31, C23C 16/448

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/006609

(22) 国際出願日:

2004年5月11日(11.05.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-132607 2003 年5 月12 日 (12.05.2003) JP 特願2004-121290 2004 年4 月16 日 (16.04.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 飯塚 八城 (IIZUKA, Hachishiro) [JP/JP].

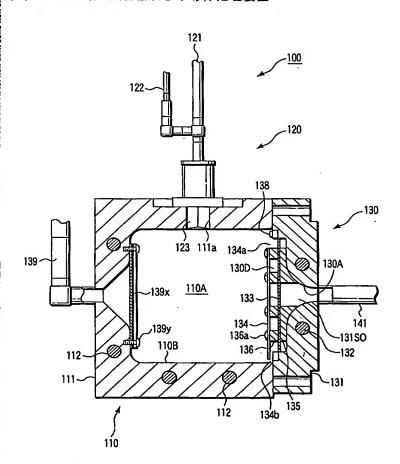
(74) 代理人: 鈴江 武彦、外(SUZUYE, Takehiko et al.); 〒 1000013 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴榮 特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有/

(54) Title: VAPORIZER AND SEMICONDUCTOR PROCESSING APPARATUS

(54) 発明の名称: 気化器及び半導体処理装置



(57) Abstract: A vaporizer comprises a vaporizing chamber (110) for vaporizing a liquid material into a gaseous material. A spraying unit (120) is arranged for spraying the liquid material into the vaporizing chamber. A delivery unit (130) is arranged for conveying the gaseous material from the vaporizing chamber to a gas exit (131SO). Heating units (112, 132) are arranged for heating the vaporizer. The delivery unit (130) comprises a filter member (133) which covers the gas exit while allowing the gaseous material to pass through. A shielding plate (134) is so arranged as to cover the filter member on the side opposite to the gas exit.

(57) 要約: 気化器は、液体原料を気化させて気体原料を形成する気化室(110) を有いる。気化室に液体原料を噴霧するため、気化室に液体原料を噴霧するため、られて変に液体原料を送出なる。気化室が配設される。気化室が配設される。送出部(130)は、気体フとのが配設される。送出部(130)は、気体フにが水がでしたがである。ガス出口を優ける。ガス出口を優ける。ガス出口を優ける。ガス出口を優ける。ガス出口を破けて、かいでは、カールを気化をでは、カールをでは、カールをでは、カールを気化を使いまする。



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

1

#### 明 細 書

気化器及び半導体処理装置 技術分野

本発明は、液体原料を気化させて気体原料を生成するための気化器及びこれを利用した半導体処理装置に関する。ここで、半導体処理とは、ウェハやLCD(Liquid crystal display)やFPD (Flat Panel Display)用のガラス基板などの被処理基板上に半導体層、絶縁層、導電層などを所定のパターンで形成することにより、該被処理基板上に半導体デバイスや、半導体デバイスに接続される配線、電極などを含む構造物を製造するために実施される種々の処理を意味する。背景技術

一般に、半導体デバイスにおける薄膜形成技術として、CVD(化学気相成長)法が知られている。半導体デバイスを製造する工程においてキャパシタを構成する場合には、デバイスの高集積化を図るために高誘電率でリーク電流の少ない誘電体薄膜に対する要請がある。このため、このような誘電体薄膜を形成する場合には、有機金属材料を原料とする成膜技術が用いられている。

上記の成膜技術において、有機金属材料である原料としては、通常、本来液体であるもの、或いは、適宜の溶媒により液状化されたものが用いられる。この原料は、気化器(原料気化器)内において霧状にされて気化され、成膜装置である反応室内に供給される。気化器においては、有機金属材料が分解されない温度で十分に気化させる必要がある。しかし、

実際には、気化していない残留ミストが生じたり、或いは、 有機金属材料の分解物がパーティクルとして発生したりする。 このため、これらのミストやパーティクルが反応室にて成膜 される薄膜の品位を低下させるという問題点がある。

そこで、従来から、気化器の出口にフィルタを設置してミストやパーティクルを除去する構成が知られている(例えば、特開平7-94426号公報、特開平8-186103号公報、米国特許第6210485号公報参照)。また、気化原料の流路に対して垂直又は流路を妨げるような角度で設けられた気化板を設け、この気化板の内部にヒータを設置して気化を促進させるといった構造も知られている(例えば、特開平6-310444号公報参照)。

また、気化チャンバ内の原料の噴霧方向に対向配置された内面部分に、他の気化チャンバの内面とは独立に温度制御可能な気化面を設けた気化器が知られている(例えば、特開2002-110546号公報参照、特にその図7及び図8の構造)。この気化面の温度は他の内面温度よりも高くなるように設定される。従来の構造では、原料の噴霧方向に対向配置された内面部分に原料が集中的に噴霧されたとき、当該内面部分の温度低下により未気化残渣が生じる可能性がある。この気化器では、このような未気化残渣を低減させることができ、気化量の増加を図ることができる。

しかしながら、上記従来の気体原料供給系においては、ミストやパーティクルによりフィルタの目詰まりが生ずる。これによって短期間にコンダクタンスが低下してしまうと共に、

3

気化器の内部圧力が上昇する。このため、気体原料の供給量や気化器における気化効率が低下する。従って、気体原料の供給量や気化効率を確保するためには、フィルタの清掃や交換を頻繁に行わなければならず、装置の稼働率が低くなるという問題点がある。

一方、上記従来のヒータ内蔵の気化板を用いる方法では、 気化板によるミストの捕捉率を高めようとすると、気体原料 の通気経路に広く張り出すように設置する必要がある。この 場合、気化器の気化効率が低下するという問題点がある。ま た、このような気化板では、パーティクルに対する捕捉効果 はほとんど期待できないという問題点もある。

更に、上記従来の独立に温度制御可能な気化面を設けた気化器においては、原料の噴霧方向に対向配置された内面部分の温度を独立に制御する。これにより、気化チャンバ内の原料の気化効率を高める。しかし、この気化面に接触しないミストに対してはほとんど影響を与えることができない。このため、当該気化面を経由することなく直接に気化チャンバの出口であるガス導出口に向かう未気化残渣やパーティクルの排出を抑制することができないという問題点がある。

### 発明の開示

本発明の目的は、気体原料中のミスト及びパーティクルを低減できる気化器を提供することにある。

本発明者は、本発明の開発の過程において、この種の気化器について研究を行い、その結果、以下に述べるような知見を得た。

4

即ち、気化器などの第1気化部において気化されて生成された気体原料の通過経路(第2気化部)にフィルタ部材を配置し、このフィルタ部材を実質的に第1気化部の加熱温度と同様の温度となるように加熱することにより、気体原料中に含まれる残留ミストを捕捉すると同時に再気化させることができる。これによって、気体原料中の残留ミストやパーティクルを捕捉することができ、高純度の気体原料を供給できる。また、捕捉された残留ミストは加熱されたフィルタ部材によって再気化されるため、フィルタ部材の目詰まりも低減される。このため、気化器内の気化効率も長期間維持され、気化器の内部圧力の上昇も抑制される。従って、メンテナンスの頻度も低減され、装置の稼働率を向上させることができる。

ところで、フィルタ部材の加熱態様としては、フィルタ部材の外部に加熱手段を設け、外部からフィルタ部材の内部に加熱手段を設け、フィルタ部材の内部に加熱手段を設け、フィルタ部材を加熱する。前者の場合と、フィルタ部材を加熱することになかった。カーにはないので、フィルタ部材を均一になると、捕捉されたことの加熱温度にばらつきが発生し、フィルタ部材に局所部材の取消を対しても、カーに接触するように加熱しても、フィルタの中央部はガストに接触することによって冷却されて温度が低下する。ことに接触することによって冷却されて温度が低下する。ことによって冷却されて温度が低下する。

のため、ミストを気化させることができず、目詰まりを招く といった問題点がある。

本発明の第1の視点は、気化原料の供給構造であって、原料を気化する第1気化部と、該第1気化部にて気化された気体原料の通過経路に設けられた第2気化部とを有し、前記第2気化部には、前記通過経路に配置された通気性を有するフィルタ部材と、前記フィルタ部材の外縁部以外の部位に熱接触して加熱手段にて発生した熱を伝える伝熱部とを有する。

第1の視点によれば、第1気化部によって原料が一旦気化 された後に、気体原料中の残留ミストを第2気化部によって 再度気化させることができるため、気体原料中のミストを低 減することができる。また、伝熱部によって加熱手段にて発 生した熱がフィルタ部材の外縁部以外の部位に伝えられるた め、フィルタ部材の温度を均一化することが可能になり、そ の結果、フィルタ部材においてより均一に、或いは、より広 い面積においてミストを気化させることが可能になる。また、 局所的な原料の集中付着が生じにくくなるので、フィルタ部 材の目詰まりを低減することができる。この場合、気化器内 の気化効率の低下や第1気化部の内部圧力の上昇などを抑制 できるため、気化器の連続動作可能時間を大幅に増大させる ことができる。また、清掃や交換などのメンテナンス作業を 容易にすることができる。また、フィルタ部材により第1気 化部で発生したミストやパーティクルを捕捉することができ るため、気体原料を用いた高品位の処理を行うことが可能に なる。

6

ここで、フィルタ部材としては、例えば、多孔質 (ポーラス) 構造、細孔を多数有する板状構造、繊維状物質を圧縮した構造、網目 (メッシュ) 構造などを有するものを挙げることができる。

なお、フィルタ部材の複数の部位に夫々熱接触する複数の上記伝熱部が設けられていることが望ましい。これによって、フィルタ部材の温度の均一性をより高めることが可能になる。これらの複数の伝熱部が熱接触するフィルタ部材の部位は、上記通過経路の断面(気体原料の流路方向と直交する仮想平面)上においてほぼ均一に分散配置されることが望ましい。ここで、フィルタ部材は、その外縁部もまた加熱されることが望ましい。

また、上記の伝熱部としては、加熱手段若しくは加熱手段を内蔵した部材に設けられフィルタ部材に向けて突出した突起、加熱手段若しくは加熱手段を内蔵した部材とフィルタ部材との間に介挿される別部材、フィルタ部材に設けられ加熱手段を内蔵した部材に向けて突出した突出した部材に向けて突出した突出のいずれであってもよい。また、加熱手段若しくは加熱手段を内蔵した部材と、伝熱部と、フィルタ部材のうちの少なくとも2つを相互に固定するための固定ネジなどの固定手段が設けられていることが望ましい。

この場合に、前記伝熱部若しくは前記フィルタ部材の温度に基づいて温度制御を行うことが好ましい。加熱手段から熱を受ける伝熱部或いはフィルタ部材の温度に基づいて温度制御を行うことにより、フィルタ部材の温度制御性を向上させ

ることができる。例えば、伝熱部若しくはフィルタ部材の内部に温度センサの温度検出点を配置し、この温度センサの出力に基づいて加熱手段を温度制御回路などにより制御することができる。また、伝熱部若しくはフィルタ部材に、チャンバとは別の加熱手段を設けてもよい。この場合、当該加熱手段による伝熱部若しくはフィルタ部材の温度はチャンバと同じ温度になるように制御されることが好ましい。

本発明の第2の視点は、気化原料の供給構造であって、原料を気化する第1気化部と、該第1気化部にて気化された気体原料の通過経路に設けられた第2気化部とを有し、前記第2気化部には、前記通過経路に配置された通気性を有するフィルタ部材と、該フィルタ部材の内部に配置された加熱手段とを有する。

第2の視点によれば、フィルタ部材の内部に加熱手段を配置することにより、フィルタ部材を効率的に加熱できると共にその表面温度のばらつきを低減することができる。このため、ミストや固形物をフィルタ部材でトラップし、付着した残留ミストを均一に気化させることが可能になる。その結果、フィルタ部材に局所的に残留ミストが堆積して目詰まりを起したり、パーティクルが発生したりすることを防止できる。

ここで、第1及び第2の視点において、第1気化部は、例 えば、従来公知の気化器として構成することができる。この 気化器としては、加熱された内面を備えた気化室と、この気 化室内に原料を噴霧する噴霧手段とを備えたものを挙げるこ とができる。また、第2気化部は、気化器の下流側に接続さ

8

れたラインフィルタなどにより構成することができる。なお、 気化原料の供給構造としては、上記第1気化部及び第2気化 部を共に単一の気化器内に設けたものであってもよい。

本発明の第3の視点は、反応処理装置(半導体処理装置)であって、上記のいずれかに記載の気化原料の供給構造と、該供給構造によって供給される気体原料を反応させる反応生を有する。これによって、気化原料の供給構造によって供給される気体原料中のミストや固形物等のパーティクルを量を低減することができる。この反応処理装置としては、気体原料を低減することができる。この反応処理装置としては、気体原料を整要のエネルギーを用いて反応室内において反応は半導体気相成膜装置、水晶気相成膜装置、化合物半導体気相成膜装置、液晶気相成膜装置、化合物半導体気相成膜装置、アチング装置など、を広く包含する。特に、気相成膜装置(CVD装置)である場合には、高品位の薄膜を形成するとできわめて効果的である。

本発明の第4の視点は、原料を気化させるための気化室と、該気化室に原料を噴霧する噴霧手段と、前記気化室に開口し、気体原料を原料供給ラインに送出するための送出部とを有する気化器において、前記送出部に設置された、通気性を有するフィルタ部材と、前記フィルタ部材の外縁部以外の部位に熱接触して加熱手段にて発生した熱を伝える伝熱部とを有する。

これによって、気化器の送出部内において残留ミストが再 気化されたり、固形物がトラップされたりする。このため、 供給される気体原料中のミストや固形物の量を低減することができる。ここで、フィルタ部材には、伝熱部によって外縁部以外の部位に加熱手段の熱が伝達されるため、フィルタ部材の温度のばらつきが低減される。このため、より均一な再気化作用を得ることができ、フィルタ部材における局部的な原料の堆積(目詰まり)を低減することができる。また、気化室で発生したミストやパーティクルを捕捉することが可能にるため、気体原料を用いた高品位の処理を行うことが可能になる。

この場合に、前記伝熱部若しくは前記フィルタ部材の温度に基づいて温度制御を行うことが好ましい。加熱手段から熱を受ける伝熱部或いはフィルタ部材の温度制御性を向上といり、フィルタ部材の温度制御性を向上とができる。例えば、伝熱部若しくはフィルタ部材の出度をとができる。例えば、伝熱部若しくはフィルタ部材に、この温度を温度制御回路などにより制御に、から、は別に加熱手段を設けてもよい。この場合、チャンバとは別に加熱手段を設けてもよい。この場合、チャンバとは別に加熱手段を設けてもよい。この場合、チャンバとは別に加熱手段を設けてもよい。

なお、フィルタ部材の複数の部位に夫々熱接触する複数の 上記伝熱部が設けられていることが望ましい。これによって、 フィルタ部材の温度の均一性をより高めることが可能になる。 これらの複数の伝熱部が熱接触するフィルタ部材の部位は、 上記送出部の断面(気化室から送出部に向かう方向と直交す る平面)上においてほぼ均一に分散配置されることが望ましい。

本発明の第5の視点は、原料を気化させるための気化室と、 該気化室に原料を噴霧する噴霧手段と、前記気化室に開口し、 気体原料を原料供給ラインに送出するための送出部とを有す る気化器において、前記送出部に設置された、通気性を有す るフィルタ部材と、該フィルタ部材の内部に配置された加熱 手段とを有する。

第5の視点において、前記気化室の内部と前記フィルタ部材との間に遮蔽板が配置されることが好ましい。遮蔽板を配置することによって、気化室から送出部に進入したミストがフィルタ部材に直接接触しにくくなる。このため、気化室において気化されずにそのまま直接送出部を通過する残留ミストの量を低減することができる。その結果、フィルタ部材にミストが付着して、気化されずに堆積したり、フィルタ部材から多くの熱を奪って局所的に温度を低下させたりする事態を回避できる。

また、前記フィルタ部材は、前記送出部のみを取り外し若しくは分解することにより着脱可能に構成されることが好ましい。これによれば、気化器の他の構成部分、例えば、噴霧手段や気化室全体を分解しなくても、送出部を取り外し、或いは、分解するだけでフィルタ部材を取り外したり装着したりすることができる。このため、フィルタ部材の清掃や交換などのメンテナンス作業を容易に行うことができる。

本発明の第6の視点は、原料を気化させるための気化室と、

1 1

該気化室に原料を噴霧する噴霧手段と、前記気化室に開口し、 気体原料を原料供給ラインに送出するための送出部とを有す る気化器において、前記気化室に臨む位置において流通開口 部を確保しつつ前記送出部を覆うように配置された遮蔽板と、 該遮蔽板に熱接触して加熱手段にて発生した熱を伝える伝熱 部とを有する。

第6の視点によれば、気化室に臨む位置において送出部を 覆うように遮蔽板を配置することで、気化室で気化されない 残留ミストやパーティクルが直接に送出部に到達することを 防止できる。このため、原料供給ラインに到達する残留ミストやパーティクルを低減できる。また、遮蔽板には伝熱部を 介して加熱手段の熱が伝達されるため、加熱された遮蔽板を のものによっても気化作用を果たすことができる。このため、 残留ミストを遮蔽板によって気化させることにより気化効率 を向上させることができる。なお、気化室や遮蔽板によって 気化された気体原料は、上記流通開口部を通して送出部の内 部空間に導入され、やがて原料供給ラインへ送出される。

この場合に、前記遮蔽板の外縁部以外の部位に熱接触する前記伝熱部を有することが好ましい。これによって、遮蔽板の温度均一性を向上できる。また、前記伝熱部若しくは前記遮蔽板の温度に基づいて温度制御を行う温度制御手段を有することが好ましい。

本発明の第7の視点は、原料を気化させるための気化室と、 該気化室に原料を噴霧する噴霧手段と、前記気化室に開口し、 気体原料を原料供給ラインに送出するための送出部とを有す

る気化器において、前記気化室に臨む位置において流通開口部を確保しつつ前記送出部を覆うように配置された遮蔽板と、該遮蔽板の内部に配置された加熱手段とを有する。

第7の視点によれば、気化室に臨む位置において送出部を 覆うように遮蔽板を配置することで、気化室で気化されない 残留ミストやパーティクルが直接に送出部に到達することを 防止できる。このため、原料供給ラインに到達する残留ミストやパーティクルを低減できる。また、遮蔽板の内部には加 熱手段が配置されるので、加熱された遮蔽板そのものによって も気化作用を果たすことができる。このため、残留ミストを を遮蔽板によって気化させることにより気化効率を向上された を遮蔽板によって気化させることにより気化効率を向上された 気体原料は、上記流通開口部を通して送出部の内部空間に導 入され、やがて原料供給ラインへ送出される。

本発明の第8の視点は、原料を気化させるための気化面を備えた気化室と、該気化室に原料を噴霧する噴霧手段と、前記気化室の前記気化面を加熱する加熱手段と、前記気化室に開口し、気体原料を原料供給ラインに送出するための送出部とを有する気化器において、前記気化面とは別に前記気化室に臨み、前記気化室から前記送出部への流通開口部を確保しつつ前記送出部を覆うように遮蔽する遮蔽板が配置され、前記遮蔽板は、前記加熱手段とは別の加熱手段により加熱され、前記遮蔽板の設定温度は、前記気化面の設定温度と同一である。

第8の視点によれば、遮蔽板の加熱温度が気化面と同一温

1 3

度に設定されることにより、遮蔽板においてミストを気化させることができる。このため、遮蔽板によって送出部への残留ミストや固形物の流入を阻止しつつ、気化効率を向上させることができる。

この場合に、前記送出部には、前記送出部の内面及び前記 遮蔽板に熱接触した複数の熱伝導柱が分散配置されることが 好ましい。送出部において、その内面と遮蔽板とに熱接触し た複数の熱伝導柱が分散配置されることにより、流通開口部 を通過して送出部に進入した残留ミストを捕捉し、気化させ ることが可能になる。このため、気化効率の向上やパーティ クルの低減を更に図ることができる。

前記遮蔽板は、前記気化室から前記流通開口部を通して直線状に前記送出部を通過できないように構成されることが好ましい。これによって、流通開口部を通して送出部に進入したミストや固形物がそれよりも下流側に流出することを抑制できる。特に、送出部に進入したミストが送出部の内面に当って気化することにより、気化効率を更に高めることができる。

本発明の第9の視点は、原料を気化させるための気化室と、該気化室に原料を噴霧する噴霧手段と、前記気化室に開口し、気体原料を原料供給ラインに送出するための送出部とを有する気化器において、前記送出部に設置されたフィルタ部材と、前記気化室に臨む位置において流通開口部を確保しつつ前記フィルタ部材を覆うように配置され、加熱された遮蔽板とを有する。

14

第9の視点によれば、送出部にフィルタ部材を設置すると 共に、気化室に臨む位置においてフィルタ部材を覆うように 遮蔽板を設ける。これにより、残留ミストやパーティクルが フィルタ部材に直接到達することを抑制でき、フィルタ部材 の目詰まりを低減することができる。このため、メンテナン スを容易にすることができると共に、加熱された遮蔽板によ って残留ミストが気化されるため、気化効率を高めることが できる。

第10の視点によれば、フィルタ部材及び遮蔽板の加熱温度が気化面と同一温度に設定されることにより、フィルタ部材及び遮蔽板においてミストを気化させることができる。このため、フィルタ部材及び遮蔽板によって送出部への残留ミストや固形物の流入を阻止しつつ、また、遮蔽板によってフ

イルタ部材への残留ミストの到達量を制限しつつ、気化効率 を向上させることができる。

前記遮蔽板は、前記気化室から前記流通開口部に導入された仮想直線が前記フィルタ部材に到達しないように構成されることが好ましい。これによれば、気化室から流通開口部を通して送出部に入る残留ミストが直接にフィルタ部材に通過することを低減できる。このため、フィルタの目詰まりを更に低減でき、特に、フィルタの一部に堆積物が集中するといったことを抑制できる。

前記フィルタ部材と前記遮蔽板との間には、前記フィルタ部材の全面に亘って気体原料が通過可能な間隔が設けられていることが好ましい。これによれば、流通開口部から送出部に進入した気体原料がフィルタ部材の全面を通過できるため、気体原料のコンダクタンスを確保できる。これと共に、フィルタ部材の一部においてミストや固形物が集中的に捕捉され、当該一部においてフィルタ部材が目詰まりを起こす可能性を低減できる。この場合、フィルタ部材と遮蔽板との間の間隔は、1~100mmの範囲内であることが好ましく、約5mmであることが最も望ましい。

前記遮蔽板は、前記気化室側から見て前記フィルタ部材の 全面を覆うように配置されることが好ましい。これによって、 気化室から進入したミストや固形物がフィルタ部材に直接向 かうことを防止できる。特に、遮蔽板がフィルタ部材の外縁 よりも全周に亘って更に外周側に張り出すように構成される

1 6

ことがより望ましい。

前記フィルタ部材の外縁部が前記送出部の内面に固定されることが好ましい。

前記流通開口部は、前記遮蔽板の周囲の全周に亘って前記 気化室と前記フィルタ部材とを連通させるように設けられて いることが好ましい。これによれば、気体原料を流通開口部 からフィルタ部材へ向けてスムーズに気体原料を流通させる ことができると共に、フィルタ部材によるミストや固形物の 捕捉場所の偏りも低減できる。ここで、上記間隙は、0.5 mmから100mmの範囲内であることが好ましく、特に、 10mm以下であることがより好ましく、約2mm程度であることが最も望ましい。

前記流通開口部は、前記遮蔽板の周囲に設けられていることが好ましい。これによれば、遮蔽板を簡易な構造に構成できると共に、遮蔽板や流通開口部の近傍の清掃などのメンテナンスが容易になる。この場合、流通開口部の開口幅(遮蔽板とその外周側にある送出部の内面との距離)は、0.5mm以上10mm以下であることが好ましく、特に、1mm以上であることがより好ましく、約2mm程度であることが最も望ましい。

また、気化室から送出部までの気体原料の流路は、上記の連通開口部の開口幅で規定される第1流路部と、この第1流路部に連通するフィルタ部材と遮蔽板との間隔で規定される第2流路部とを含む。この場合、第1流路部から進入したミストや固形物が直線的に進んで第2流路部に到達しないよう

に構成されることが好ましい。また、フィルタ部材の外縁部が固定される場合には、上記気体原料の流路は、遮蔽板とフィルタ部材の外縁部との間隙で規定される第3流路部を含み、この第3流路部は第1流路部と第2流路部とを連通するように配設される。この場合、第3流路部が形成されることにより、第1流路部から進入したミストや固形物が直線的に進んで第2流路部に到達しないように構成されることが好ましい。

前記フィルタ部材は気体原料の流路方向に貫通する細孔を多数設けた板状材であることが好ましい。このように簡易な板状材でフィルタ部材を構成することによって、フィルタ部材中に加熱手段を容易に収容配置することが可能になる。また、フィルタ部材自体の熱伝導性も高めることも容易になる、フィルタ部材の温度分布の均一性を高めることも容易になる。この細孔は、開口径よりも貫通距離が大きい形状、例えば、0.1~1.0mm程度の直径、5~15mmの範囲内の貫通距離を有するものが残留ミストの捕捉率を確保するために望ましい。

本発明の第11の視点は、反応処理装置であって、上記のいずれかに記載の気化器と、該気化器から供給される気体原料を反応させる反応室とを有する。これによって、気化器から供給される気体原料中のミストやパーティクルの量を低減することができるため、反応室における処理品位を向上させることができる。この反応処理装置としては、気体原料を、熱エネルギーを加える等の何らかの態様で反応室内において反応させることによって種々の処理を行うもの、例えば半導

体気相成膜装置、液晶気相成膜装置、化合物半導体気相成膜装置、気相エッチング装置などの半導体処理装置を広く包含する。特に、気相成膜装置(CVD装置)である場合に効果的である。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明の第1実施形態に係る気化器の構造を示す概略断面図。

図2Aは、第1実施形態の気化器の送出部の構造を示す概略内部側面図、図2B、C、Dは、第1実施形態の変更例を示す内部側面図。

図3A、Bは、本発明の第2実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図4A、Bは、本発明の第3実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図 5 A、 B は、本発明の第 4 実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図、図 5 C は、加熱手段の変更例を示す概略断面図。

図 6 A、 B は、本発明の第 5 実施形態に係る気化器の主要 部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図7A、Bは、本発明の第6実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図8A、Bは、本発明の第7実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図9A、Bは、本発明の第8実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図10A、Bは、本発明の第9実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図11A、Bは、本発明の第10実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図12A、Bは、本発明の第11実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図13A、Bは、本発明の第12実施形態に係る気化器の 主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図14A、Bは、本発明の第13実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図。

図15は、本発明の第14実施形態に係る気化器を示す概略縦断面図。

図16は、図15のA-A線に沿った第14実施形態の気化器を示す横断面図。

図17A、Bは、本発明の第15実施形態及び第16実施 形態に係る気化器を示す概略縦断面図。

図18A、Bは、本発明の第17実施形態及び第18実施 形態に係る気化器を示す概略縦断面図。

図19は、本発明の第19実施形態に係る気化器を示す概略縦断面図。

図 2 0 A 、 B は、噴霧手段の変更例を示す概略正面図及び 概略側面図。

図20C、Dは、噴霧手段の別の変更例を示す概略正面図及び概略側面図。

図21は、本発明の実施形態に係る反応処理装置(半導体

処理装置)を示す概略構成図。

図22は、原料供給部の内部構成を示す概略構成図。

図23は、本発明の別の実施形態に係る反応処理装置(半導体処理装置)を示す概略構成図。

図24は、気化室の内圧の時間的変化について、第2実施 形態の気化器と従来の気化器とで比較して示すグラフ。 発明を実施するための最良の形態

以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。

### <第1実施形態>

図1は、本発明の第1実施形態に係る気化器の構造を示す 概略断面図である。この気化器100は、第1気化部に相当する気化面110B及び気化空間110Aを構成する気化室110を有する。気化空間1110Aに液体原料を噴霧するため、噴霧手段120が配設される。気化室1110に対して、第2気化部に相当する送出部130が着脱可能に取り付けられる。気化空間1110Aの内圧を検出するため、圧力ゲージ(キャパシタンスマノメータ:図示せず)を取り付ける検出用配管139が配設される。配管139に連通する気化室110の開口部には、フィルタ部材139xが取り付けられる。フィルタ部材139xは圧力ゲージへのミストや固形物の進入を防止する。フィルタ部材139xは取付部材139yによって開口縁に対して密着固定される。

気化室110は、筐体壁111と、筐体壁111内に設置されたヒータなどの加熱手段112を有する。筐体壁111は、噴霧手段120を装着する開口部111aを有する。噴霧手段120は、有機金属原料や有機金属原料を溶媒に溶かした原料などの液体原料を供給する原料供給管121を有する。噴霧手段120はまた、アルゴンガスなどの噴霧用ガス(例えばAr、Ne、N₂)を供給する噴霧用ガス供給管122と、上記の原料をミスト状に噴霧する噴霧ノズル123とを有する。噴霧ノズル123は、原料(液体、例えば有機金属材料)と噴霧用ガスを個々の細孔から噴出させることによって霧状に噴出させる。

送出部130は、気化空間1110Aにおいて気化されてなる気体原料を、供給ライン141に送出する部分である。送出部130は側壁131を有し、側壁131の気化空間110A側に凹部状に内部空間130Aが形成される。内部空間130A内に凸部状に突出して柱状の伝熱部が配設される。側壁131の内部(収容孔131a、図2参照)にヒータなどの加熱手段132が配置される。送出部130の内部空間130Aは、上記気化空間110Aと、供給ライン141とに連通する。なお、送出部130は、気化空間111Aに面する位置であれば、気化空間110Aのいずれの側に配置されていてもよい。

内部空間 1 3 0 A には、供給ライン 1 4 1 への送出口(ガス出口) 1 3 1 S O を覆うようにフィルタ部材 1 3 3 が配置される。フィルタ部材 1 3 3 としては、通気性のあるフィル

2 2

タ板として構成されるものを用いることができる。例えば、 多孔質材料、細孔を多数備えたフィルタ板、繊維を押し固め た材料、網目(メッシュ)材などで構成されたフィルタ部材 を挙げることができる。より具体的には、高温(例えば、1 80℃~350℃程度、ただし、原料の気化温度や分解温度 によって適宜に設定される)に耐えられる金属繊維(例えば ステンレス鋼繊維)を不織布状や焼結状に固めたフィルタ材 料を用いることができる。例えば、上記金属繊維の径は0. 1~3.0mm程度である。特に、熱伝導性の高い、球状そ の他の粒状材料を焼結してなる焼結材を用いることが好まし い。粒状材料の構成素材としては、セラミックス、石英など の非金属材料や、ステンレス鋼、アルミニウム、チタン、ニ ッケルなどの非鉄金属材料及びこれらの合金材料などを挙げ ることができる。なお、フィルタ部材の構造及び材料に関す る上述の態様の範囲は、以下に述べる全ての実施形態に共通 である。

図2Aは、上記送出部130を気化空間110A側から見た様子を示す内部側面図である。フィルタ部材133の外縁部は、上記内部空間130Aの流通断面を全て覆うように周囲の側壁131に接触し接続固定される。より具体的には、フィルタ部材133の外縁部は固定ネジ138等により側壁131に固定される。フィルタ部材133の上記外縁部以外の部位には、側壁131より内側に突出する伝熱部135、137が配設される。より具体的には、フィルタ部材133が伝熱部135、137を介して側壁131に熱接触する。

2 3

即ち、伝熱部135、137は、フィルタ部材133を支持する支持部材としても機能する。伝熱部135、137は、熱伝導性の良い金属(例えばステンレス鋼など)により構成される。伝熱部135は横断面が長円形の柱状に構成され、伝熱部137は横断面が円形の柱状に構成される。これらの伝熱部135、137は、図示例では側壁131内に配置されたヒータ等の加熱手段で加熱される。ただし、伝熱部が加熱手段自体で構成されていてもよく、また、伝熱部の内部に加熱手段を埋め込んでも構わない。

フィルタ部材133の気化空間110A側には、遮蔽板134が配置される。遮蔽板134は、例えば、ステンレス網などの熱伝導性金属材料で構成される。遮蔽板134は、気気化空間110Aに面し、噴霧ノズル123から噴霧されるよりが直接にフィルタ部材133に付着しない下がになった。これによって、フィルタ部材133の温度低下によった。ストを確実に気化されることが可能によった。ストを確実に気が低減。される。で、フィルタ部材133の目詰まりが低減。3~2 をの間には、フィルタ部材133の全面に互って、気の間には、フィルタ部材133の全面に対ス通路で、気の間には、フィルタ部材133の全面に対ス通路で、13~3~2 をの間には、フィルタ部材133の全面に対ス通路で、13~3~2 を介して遮蔽板134及びフィルタ部材133が加熱される。

遮蔽板134の周囲には流通開口部134bが設けられ、

流通開口部134bにより気化空間110Aと内部空間13 0Aとが連通して気化された気体原料が効率良く送出される。 また、遮蔽板134には、噴霧ノズル123側に開口部13 4aが形成される。開口部134aによって上記間隙の開口 面積が大きくなるため、気化空間110Aからフィルタ部材 133の配置された内部空間130Aへ向かう気体原料が流 れやすくなる。開口部134aが形成されるのは、噴霧ノズ ル123の噴射角度範囲が実質的に限定されるために、噴霧 ノズル123側においては噴霧ノズル123から噴霧される ミストが送出部130へ直接到達しにくいからである。

図2B、C、Dは、遮蔽板の変更例を示す内部側面図である。図2Bに示す遮蔽板134′では、フィルタ部材133と重なる位置において外周に沿って連続的に、或いは、外周全体に開口部134a′が形成される。図2Cに示す遮蔽板134″では、フィルタ部材133の外周部に対応するように、外周に沿って複数の開口部134a″が離散的に形成される。なお、遮蔽板に形成される開口部は、スリット状(同心円状の場合も含む)であってもよい。

図2Dに示す遮蔽板134Xでは、それ自体に開口部が形成されておらず、従って遮蔽板134Xはフィルタ部材133の全体を覆う。この場合、遮蔽板の周囲の流通開口部134b(図1及び図2A参照)により、気化空間110Aと内部空間130Aとの連通が十分に得られるようにする。なお、図2Dに示すように、遮蔽板134Xがフィルタ部材133の全体を覆うと、原料の残留ミストが直接フィルタ部材13

3に付着し難くなるという利点が得られる。

遮蔽板134は、上記フィルタ部材133と共に、スペーサ136を介して伝熱部135に固定される。スペーサ136は、伝熱性の良い部材、例えばA1やステンレス鋼等の金属、セラミックスなどで構成される。なお、固定ねじ136に破蔽板134及びスペーサ136を伝熱部135に固定するためにも用いられる。フィルタ部材133を伝熱部137に固定するためにも用いられる。フィルタ部材133及び遮蔽板134は、伝熱部135及びスペーサ136を介して熱接触する加熱手段132から放出される熱を受けると共に、気化空間110Aに臨む気化室110の筐体壁111の内面からの輻射熱を受けることにより加熱される。

この実施形態においては、原料供給管121から供給される原料は噴霧ノズル123において気化空間110Aに噴霧される。ここで噴霧された原料のミストは、一部が飛行中に気化すると共に、別の一部は、加熱手段112によって加熱される筺体壁111の内面に到達することによって加熱される、原料を気化するためには、気化室110、特に筺体壁111の内面は、加熱手段112によって原料の分解温度より低く、原料の気化温度より高い温度範囲に加熱される。この温度は、例えば、100~350℃程度である。

このようにして気化空間1110Aにて生成された気体原料は、遮蔽板134の周囲からフィルタ部材133を通過して内部空間130Aに導入される。内部空間130Aに導入さ

れた気体原料には、気化空間110Aにおいて気化されない 微細な残留ミストが含まれる。これらの残留ミストは、フィ ルタ部材133に到達して捕捉され、ここで加熱手段132 から伝熱部135、137を介してフィルタ部材133に伝 えられた熱によって加熱され、再気化される。フィルタ部材 133もまた、上記気化室と実質的に同じ温度範囲になるよ うに加熱されることが好ましい。

なお、上記の伝熱部135、137は、気体原料の流路断面においてフィルタ部材133の全体に亘ってほぼ均一に分散配置されることが好ましい。これによって、フィルタ部材133をより均一に加熱することが可能になり、残留ミストの気化効率を向上させることができ、また、フィルタ部材の目詰まりをより低減できる。

図示例では、フィルタ部材の外縁部が送出部の内面に接触 (接続固定)することにより、当該内面からもその外縁部が 熱を受け加熱される。なお、上記伝熱部に加熱手段を設ける ことによりフィルタ部材を加熱するようにしてもよい。

遮蔽板134は、噴霧ノズル123から噴霧されるミストが直接にフィルタ部材133に到達することを防止する。このため、フィルタ部材133が大量のミストによって熱を奪われ、その結果、付着したミストを気化させる能力が所定箇所において部分的に低下するといったことが防止される。従って、当該箇所において目詰まりを起こすことにより、気体原料の送出量が低下することや、気化室内の圧力が上昇することが防止される。

2 7

上記実施形態において、送出部130は、側壁131を筐体壁111から取り外すことによって、簡単にフィルタ部材133を取り出すことができるように構成される。従って、フィルタ部材133に目詰まりなどの問題が発生したときには、きわめて簡単かつ迅速にフィルタ部材133を取り外し、清掃したり、或いは、新たなフィルタ部材に交換したりすることができる。このため、メンテナンス時間が短縮され、装置の稼働率が向上し、歩留まりも向上する。

本実施形態では、伝熱部135、137を介して遮蔽板134に熱が伝えられ、遮蔽板134も加熱される。このため、遮蔽板134に気化室110A内の原料ミストが直接当ると、遮蔽板134の表面でもミストが気化する。ただし、遮蔽板134の表面でもミストが気化する。ただし、遮蔽板134の温度は低下する。遮蔽板134の温度の低下量は、噴霧される液体原料の量に応じて遮蔽板134に当るミストの量が変化することによっても変化する。通常、遮蔽板134の温度は、気化室110の設定温度に対して5~15℃程度低くなる。

上記フィルタ部材133は、遮蔽板134に対して送出路側に近い位置に配置されていればよい。例えば、通常、フィルタ部材133と遮蔽板134の間隔130Dは、1~100mmの範囲内であり、特に、1~50mmの範囲内であることが好ましく、更に2~10mmの範囲内であることがよりましい。典型的には、上記距離は約5mm程度であることが最も望ましい。上記距離が上記範囲よりも小さくなると、

28

気体原料のコンダクタンスが低下し、また、残留ミストのフィルタ部材133に対する実質的な付着範囲も狭くなる。この場合、フィルタ部材133の一部に固形物が集中的に堆積する恐れがある。また、上記距離が大きくなると、気体原料のコンダクタンスが向上し、フィルタ部材133の局部的な固形物の付着も緩和されるが、その代わりに気化器の大型化を招く。

遮蔽板134の外縁と、その外周側に配置された側壁13 1との間隔である上記流通開口部134bの開口幅は、気体 原料のコンダクタンスを確保する上で0.5mm以上10m m以下であることが好ましく、1mm以上であることがより 好ましい。ただし、上記開口幅が大きくなるとミストがフィ ルタ部材133に直接到達する危険性が増大するので、約2 mm程度であることが最も望ましい。

更に、遮蔽板134の外縁と、その内部空間130A側に配置されたフィルタ部材133との間の間隙(内部空間130A内の流路幅)は、0.5mm~100mmの範囲内であることが好ましく、また、0.5mm~10mmの範囲内であることがより好ましい。更に、この間隔は、約2mm程度であることが最も望ましい。この間隔が小さくなると気体原料のコンダクタンスが低下する。逆に間隔が大きくなると、流通開口部130Bから進入したミストが直接フィルタ部材133に到達しやすくなる。

気化室110Aから送出部130までの気体原料の流路は、 上記の連通開口部134bの開口幅で規定される第1流路部 と、この第1流路部に連通するフィルタ部材133と遮蔽板134との間隔で規定される第2流路部とを含む。この場合、第1流路部から進入したミストや固形物が直線的に進んで第2流路部に到達しないように構成される場合には、上記気体原料の流路は、遮蔽板134とフィルタ部材133との間隙で規定される第3流路部を含み、この第3流路部は第1流路部と第2流路部とを連通するように配設される。この場合、第3流路部が形成されることにより、第1流路部に到達しないように構成されることが好ましい。

## <第2実施形態>

図3A、Bは、本発明の第2実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図3A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部150を示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。

本実施形態において、送出部150は側壁151を有し、側壁151の気化空間側に凹状に内部空間150Aが形成される。空間150Aの内部に側壁151より凸部状に突出する伝熱部155、157が配設される。この側壁の内部(収容孔151a)に上記と同様の加熱手段152が配置される。内部空間150Aは送出路150Sに連通する。内部空間150Aには、上記と同様のフィルタ部材153が配置される。フィルタ部材153は、側壁151の内面に設けられた第1

3 0

実施形態と同様の突起状の伝熱部155、157に熱接触する。伝熱部155は長円形状などの延長された断面形状を有する柱状部である。伝熱部157は円形状の断面形状を有する柱状部である。この柱状部は、フィルタ部材153を遮して伝熱しやすいものであればどのような形状でもよい。例えば、柱状部の形状は、フィルタ部材153の外縁部は固定ねじ158等により側壁151に固定される。伝熱部155、157の個数や配置は、フィルタ部は53に対して均一に熱を伝えることができるように設定される。

伝熱部155、157には、スペーサ156を介して遮蔽板154が固定ねじ156aにより取付固定される。遮蔽板154とフィルタ部材153の全面に直って空間部150Dが形成される。遮蔽板154は3の全面に直って空間部150Dが形成される。遮蔽板154は円形の平面形状を有する。遮蔽板154はフィルタ部材153を全て平面的に覆うように構成され、変板を154なの外縁と、その周囲の側壁151との間に設けられた円周状の間隙が流通開口部150Bとなっている。このようによりの間隙が流通開口部150Bとなっている。このようは状の原料が直接フィルタ部材153を全て平面的に覆うよが水の原料が直接フィルタ部材153を全て平面的に覆りが流速であることによって、霧状の原料が直接フィルタ部材153に構成されることによって、霧状の原料が直接フィルタ部材153に対象状の原料が直接フィルタ方部材153に表別の局部集中を起こって、現間する。これにより、気化室の圧力上昇を抑制すると共に、フィルタ寿命を延ばしつつ、残留ミストやパーティクルが下

流側へ送出されることを防止できる。

以上説明した各部は基本的には上記第1実施形態と同様に構成される。従って、フィルタ部材153は、その外縁部において側壁151から直接加熱手段152の熱を受けるだけでなく、外縁部以外の部分に熱接触する伝熱部155、157を介して加熱手段152の熱を受けるように構成される。 遮蔽板154は、スペーサ156を介してフィルタ部材153及び伝熱部155、157により加熱される。

本実施形態では、気化室で気化された気体原料は、流通閉口部150Bを通過して送出部150の内部空間150A内に導入され、フィルタ部材153を通過した後に送出路150Sから供給ラインに送出されるように構成される。

ここで、上記の流通開口部150Bは、気化室側から流通開口部150Bに進入する任意の仮想直線を形成したとき、いずれの仮想直線もフィルタ部材153に到達しないように構成される。即ち、気化室内の残留ミストがどのような設定のように満しないが直接フィルタ部材153に付着しないように構成される。具体的には、流通開口部150Bの経方向の開口部分に達しないように流通開口部150Bの径方向の開口部分に達しないように流通開口部150Bの径方向の開口部分に達しないように流通開口部150Bの径方向の開口部分に達しないように流通開口部150Bの径方向の開口をされる。

なお、送出部150の各部のパラメータは第1実施形態と同じである。例えば、流通開口部150Bの半径方向の開口

幅が2mm、遮蔽板154とフィルタ部材153の外縁部の軸線方向の間隔が2mm、遮蔽板154とフィルタ部材153の外縁部の11隔が5mm、フィルタ部材153の外縁部の間隔が5mm、フィルタ部材153の外縁部の半径方向の幅が4mm、遮蔽板154の外縁位置とフィルタ部材153の実質的な外縁位置(即ち、フィルタ部分の外縁位置)との間の半径方向の距離が2mmである。これによって、フィルタ部材153上の堆積物の量を低減することができ、目詰まりや堆積物の集中を抑制できる。特に、フィルタ部材153の外周部分に堆積物が集中して付着するといったことも抑制できる。

PCT/JP2004/006609

できる。このため、フィルタ部材153の目詰まりを低減でき、気化室内の圧力上昇が抑制される。また、残留ミストやパーティクルを低減することが可能になる。

本実施形態では、伝熱部155の温度、即ちフィルタ部材 153や遮蔽板154を検出して加熱手段152が制御され ることから、第1実施形態よりも遮蔽板154の温度の制御 性が向上する。従って、第1実施形態の場合よりも遮蔽板1 54の温度低下を低減することができる。この場合、加熱手 段152の設定温度は気化室に対する設定温度と同一とする ことが好ましい。

上記フィルタ部材153は、遮蔽板154の送出路150 ス側の近傍位置に配置されていればよい。例えば、通常、ス イルタ部材153と遮蔽板154の間隔は、1~100mmの 範囲内であり、特に、1~50mmの 範囲内であり、特に、1~50mmの 範囲内であることがより りない。典型的には、上記距離は約5mm程度であることががましい。 上記距離が上記の出まりもなると、ストの のおりたがましい。また、残留ミストの タ部材153に対する実質的な付着範囲も狭くなる。この 会、フィルタ部材153の一部に固形物が集中的に堆積の の、フィルタ部材153の一部に固形物がまた、 恐れがある。また、上記距離が大きくなると、気体原料の の付着も緩和されるが、その代わりに気化器の大型化 もの付着も緩和されるが、その代わりに気化器の大型化 もの付着も緩和されるが、以下に説明する各実施形態でも である。 遮蔽板154の外縁と、その外周側に配置された側壁15 1との間隔である上記流通開口部150Bの開口幅は、気体 原料のコンダクタンスを確保する上で0.5mm以上10m m以下であることが好ましく、1mm以上であることがより 好ましい。ただし、上記開口幅が大きくなるとミストがフィ ルタ部材153に直接到達する危険性が増大するので、約2 mm程度であることが最も望ましい。なお、この点は、以下 に説明する各実施形態でも同様である。

更に、遮蔽板154の外縁と、その内部空間150A側に配置されたフィルタ部材153の外縁部との間隙(内部空間150A内の流路幅)は、0.5mm~100mmの範囲内であることが好ましく、また、0.5mm~10mmの範囲内であることがより好ましい。更に、この間隔は、約2mm程度であることが最も望ましい。この間隔が大きくなると、体原料のコンダクタンスが低下し、逆に間隔が大きくなると、流通開口部150Bから進入したミストが直接フィルタ部材153に到達しやすくなる。なお、この点は、以下に説明する各実施形態でも同様である。

気化室から送出部150までの気体原料の流路は、上記の連通開口部150Bの開口幅で規定される第1流路部と、この第1流路部に連通するフィルタ部材153と遮蔽板154との間隔で規定される第2流路部(空間部150D)とを含む。この場合、第1流路部から進入したミストや固形物が直線的に進んで第2流路部に到達しないように構成される場合が好ましい。フィルタ部材153の外縁部が固定される場合

には、上記気体原料の流路は、遮蔽板154とフィルタ部材153の外縁部との間隙で規定される第3流路部を含み、この第3流路部は第1流路部と第2流路部とを連通するように配設される。この場合、第3流路部が配設されることにより、第1流路部から進入したミストや固形物が直線的に進んで第2流路部に到達しないように構成されることが好ましい。なお、この点は、以下に説明する各実施形態でも同様である。

図4A、Bは、本発明の第3実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図4A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部150′を示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。この送出部150′のうち、第2実施形態と同様の部分には同一符号を付して示す。

この実施形態では、側壁151′にその内部空間150Aを反応処理装置への供給ラインに連通させる送出路150Sとは別に、内部空間150Aを外部(例えば、反応処理装置の排気ライン)に連通させる排出路150Cが形成される。この排出路150Cは噴霧ノズルから見て最も離間した位置、即ち、図示下端部に形成される。排出路150Cは、後述する反応処理装置の反応処理部を経由せずに排気されるバイパスライン(排気ライン(evacuation 1ine))などの排出ラインに接続される。排出路150Cは、気体原料の供給状態が安定するまで気体原料を反応処理部に導入せずに排気するために用いられる。

本実施形態において、上記排出路150Cに対応する平面位置には、フィルタ部材153′に開口部153a′が形成される。開口部153′の開口縁部は、フィルタ部材153′の外縁部の一部として設けられ、フィルタ部材153′を固定する固定ねじ158′等により隙間なく排出路150Cに接続される。

本実施形態では、遮蔽板154を避けて流通開口部150 Bを通過して内部空間150Aに侵入した気体原料は、排出路150Cに接続される排出ラインに設けられた弁V2が開いた状態において上記開口部153a′及び排出路150Cを通って直接排出される。この際、送出路150Sに接続される供給ラインの弁V1は閉鎖される。従って、反応処理部に送られない気体原料がフィルタ部材153′を通過することができる。

なお、気体原料を供給ラインへ流す場合は、排出路150 Cに接続された排出ラインの弁V2を閉鎖し、供給ラインの 弁V1を開く。これにより、今まで排出路150Cから排出 されていた気体原料は、フィルタ153′を通過して送出路 150Sから供給ラインへ導かれるようになる。

### < 第 4 実 施 形 態 >

図5A、Bは、本発明の第4実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図5A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部150″を示すものであり、その他の部分

は第1実施形態と同様である。この送出部150″のうち、第2実施形態と同様の部分には同一符号を付して示す。

この実施形態では、加熱手段152″の先端に伝熱部157″が接合された状態で側壁151″の内部(収容孔151a″)に挿入される。伝熱部157″は内部空間150A内に突出して上記各実施形態と同様にフィルタ部材153及び遮蔽板154に熱接触する。加熱手段152″は例えばロッド状のヒータであり、直接に伝熱部157″が接合されることにより、伝熱部157″を介したフィルタ部材153及び遮蔽板154の加熱を効率的に行うことができるように構成される。

本実施形態にも上記各実施形態と同様に延長された平面形状を有する伝熱部155″が配設される。その一部は上記の伝熱部157″の一つが側壁151″から挿入されて内部空間150Aに突出した状態となっている。即ち、伝熱部155″は伝熱部157″の一つを含む態様で構成される。

本実施形態において、伝熱部157″の先端にはねじ穴が形成される。伝熱部157″の先端にフィルタ部材153、スペーサ156及び遮蔽板154を順次に重ねられる。この状態で、上記のねじ穴に固定ねじ156aをねじ込むことにより、フィルタ部材153及び遮蔽板154が伝熱部157″に固定される。

図5 Cは、上記の加熱手段152″及びそれに接続される 部品の変更例を示すものである。図5 Cに示す加熱手段15 2 S″は、ロッド状のヒータの先端部にボルトを埋め込んだ ものである。上記スペーサ156の代わりに、上記のボルトに螺合するナット152T″を用意し、また、ナット152T″に螺合する固定ねじ152U″を用意する。加熱手段152S″とナット152T″と固定ねじ152U″との間に遮蔽板154を配置する。この状態で、ナット152T″を介して加熱手段152S″と固定ねじ152U″とを固定する。

このように、本実施形態では、伝熱部157を加熱手段152″の一部で構成することができる。これによって、フィルタ部材153や遮蔽板154を更に効率的に加熱することができる。従って、遮蔽板154の温度低下を更に低減することができる。この場合、加熱手段152″の設定温度は気化室に対する設定温度と同一とすることが好ましい。

### < 第 5 実 施 形 態 >

図6A、Bは、本発明の第5実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図6A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部160を示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。

送出部160は、側壁161と、側壁161の内部(収容孔161a)に配置された加熱手段162とを有する。側壁161には、内側(気化室側)から遮蔽板164が密着固定される。内部空間160Aは、側壁161と遮蔽板164との間に画成され、送出路160Sに連通する。内部空間16

3 9

0 Aには、固定ねじ1 6 8 等によりフィルタ部材1 6 3 の外縁部が固定される。フィルタ部材1 6 3 の外縁部以外の部位には、側壁1 6 1 の内面上に突設された複数の伝熱部1 6 5、1 6 7が熱接触する。フィルタ部材1 6 3 と遮蔽板1 6 4 との間にはスペーサ1 6 6 が介在し、固定ねじ1 6 6 aによって伝熱部1 6 5、1 6 6、フィルタ部材1 6 3 及び遮蔽板1 6 4 との間にはフィルタ部材1 6 3 と遮蔽板1 6 4 との間にはフィルタ部材1 6 3 と遮蔽板1 6 4 との間にはフィルタ部材1 6 3 と遮蔽板1 6 4 の間にはフィルタ部材1 6 3 を適過した後に送出路1 6 0 いが形成される。そして、フィルタ部材1 6 3 と遮蔽板1 6 4 の間に、気化したガスが通過する空間が形成され、この空間を通過したガスがフィルタ1 6 3 を通過した後に送出路1 6 0 Sへ流れるようになっている。

なお、伝熱部165は延長された平面形状を有し、伝熱部 165の内部には、上記各実施形態と同様の温度センサ16 9の温度検出点が配置される。

遮蔽板164には、複数の平面形状がスリット状に構成された流通開口部164Aが形成される。これらの流通開口部164Aは、遮蔽板164の厚さ方向に曲折(屈折著しくは湾曲)した形状を有し、気化室側から進入した残留ミストのほとので到達することのないように構成される。即ち、流通開口部164Aは、気化室側から流通開口部164Aは、気化室側から流がそのままフィルク部164Aに進入する全ての仮想直線がそのままフィルで、対163に進入する全ての仮想直線がそのままフィンで、接留ミストのほとんどが少なくとも1回は遮蔽板164に接触してから内部空間160A内に進入するように構成される。

このため、気体原料の流通を確保しながら、遮蔽板による残留ミストの気化作用を促進することができ、フィルタ部材163の目詰まりや堆積物の集中を低減できる。上記の流通開口部164Aは、遮蔽板164の面内において平行になるように複数形成されてもよく、同心円状になるように複数形成されてもよい。

以上のように、遮蔽板には流通開口部を形成することができる。なお、上記の流通開口部は、結果的に気化室側から流通開口部を通してフィルタ部材に直接達する仮想直線が存在しないように構成されていればよい。従って、上記のように曲折した孔形状でなくても、流通開口部の遮蔽板に対する貫通方向がフィルタ部材に向いていなければ、即ちフィルタ部材から外れた方位を向いていれば、上記と同様の効果を得ることができる。

### < 第 6 実 施 形 態 >

図7A、Bは、本発明の第6実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図7A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部160′を示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。送出部150′のうち、第5実施形態と同様の部分には同一符号を付して示す。

この実施形態では、遮蔽板164′には流通開口部164 A′が形成される。流通開口部164A′は、平面的に見てフィルタ部材163と重なる領域から外れた領域、即ち、フィルタ部材163よりも外周側にずれた位置に形成される。 これによって、気化室側から流通開口部164A′に進入する全ての仮想直線がフィルタ部材163に到達することのないように構成される。図示例では、流通開口部164A′は円弧状のスリット形状を有する。なお、複数の流通開口部164A′を同心円状に等間隔に形成してもよい。複数の流通開口部164A′を形成する場合には、千鳥状(互い違い)に形成してもよい。なお、温度センサ169の出力に基づいて加熱手段162を制御し、遮蔽板164′の温度を制御可能に構成される点は先の実施形態と同様である。

本実施形態では、遮蔽板164′の内部にワイヤ状のヒータなどで構成される加熱手段164日′が挿通され、遮蔽板164′を直接に加熱する。加熱手段164日′は、遮蔽板164′を蛇行状に挿通する。図示例では、加熱手段164日′を外部から遮蔽板164′に導入するが、加熱手段164日′を遮蔽板164′内に埋め込んでもよい。線状の加熱手段164日′を遮蔽板164′内に埋め込んでもよい。線状の加熱手段164日′を遮蔽板164′に

遮蔽板164′の内部には、温度センサ164TC′の温度検出点も配置される。温度制御回路CONTによって、温度センサ164TC′の検出温度に基づいて、加熱手段164H′を制御し、遮蔽板164′を直接、独立して温度制御する。これにより、遮蔽板164′の温度を最適温度に精密に設定することができるため、遮蔽板164′によるミストの気化状態を安定させることができる。この場合、加熱手段

4 2

164H′の設定温度は気化室に対する設定温度と同一とすることが好ましい。

以上のように、遮蔽板の内部に加熱手段を配置することにより、遮蔽板の温度制御性が改善される。このため、更に効率的に原料の気化を行うことができ、残留ミストやパーティクルの低減を図ることができる。

## <第7実施形態>

図8A、Bは、本発明の第7実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図8A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部150Xを示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。送出部150Xのうち、第2実施形態と同様の部分には同一符号を付して示す。

この実施形態においては、第2実施形態と同様の基本構造を有するが、第2実施形態と同様の伝熱部155、157、スペーサ156及び固定ねじ156aで構成される熱伝導柱がより多く設けられ、これらが内部空間150A内に分散配置される点で異なる。これらの熱伝導柱は、第2実施形態と同様にフィルタ部材153X及び遮蔽板154Xと熱接触する。熱伝導柱は、側壁151Xの内面と遮蔽板154Xとに共に熱接触した状態となっている。

本実施形態では、上記の熱伝導柱が送出部において多数分散配置されることにより、気化室から流通開口部 1 5 0 Bを通して気体原料と共に進入した残留ミストが熱伝導柱に接触しやすくなる。残留ミストは、熱伝導柱により加熱されて気

化し、気体原料となるため、気化効率を向上させることができる。

## < 第 8 実 施 形 態 >

図9A、Bは、本発明の第8実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図9A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部150Yを示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。送出部150Yのうち、第2実施形態と同様の部分には同一符号を付して示す。

本実施形態では、側壁151Yに複数の柱状の伝熱部157Yを形成し、伝熱部157Yに固定ねじ156aにより遮蔽板154Yを固定してある。この実施形態では、フィルタ部材は設けられておらず、その代わりに、多数の伝熱部157Yにて構成される熱伝導柱が側壁151Yの内面と遮蔽板154Yとの間に分散配置される。本実施形態では、熱伝導柱がフィルタと同様の機能を有し、流通開口部150Bから内部空間150A内に進入してきた残留ミスト及びパーティクルを捕捉して再気化するように構成される。

即ち、遮蔽板154Yが送出路150Sへの送出口(ガス出口)150SOを覆うように配設され、遮蔽板154Yと送出路150Sとの間に、気化室110(図1参照)と送出口150SOとを接続するガス通路部(原料を更に気化させる)が形成される。このガス通路部で、伝熱部157Yの熱に導柱が流体バッフルとして機能し、これがフィルタの機能を代替する。なお、この構成に加え、更にフィルタ部材を配

設することもできる。

この実施形態でも、伝熱部157Yは、流通開口部150 Bから進入した残留ミストが直接送出路150Sに流出する ことのない態様で配列される。即ち、伝熱部157Yは、流 通開口部150Bから至る内部空間150A内に進入する全 ての仮想直線が伝熱部157Yに到達するように構成される。 特に、内部空間150A内の流通開口部150B側の外周部 から送出路150S側の内周部に向けて伝熱部157Yを通 過しない仮想直線を引くことができないように、原料ガスの 流れ方向に対して略直交して、複数の伝熱部157Yが配列 される。例えば、伝熱部157Yは千鳥状に配置される。 <第9実施形態>

図10A、Bは、本発明の第9実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図10A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部150Zを示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。送出部15,0Zのうち、第2実施形態と同様の部分には同一符号を付して示す。

この実施形態では、側壁151Zに伝熱枠157Zが内側(気化室側)から取付固定される。伝熱枠157Zは、側壁151Zに直接熱接触する外枠部と、この外枠部から内側に伸びる複数の梁部157Zaとを有する。フィルタ部材153Zの外縁部は、外枠部に対して固定される。フィルタ部材153Zの外縁部以外の部位が複数の梁部157Zaに熱接触する。フィルタ部材153Zにはスペーサ156を介して

遮蔽板1542が固定ねじ156aにより固定される。本実施形態では、梁部1572a、スペーサ156及び固定ねじ156aにより、フィルタ部材1532及び遮蔽板1542が外縁部以外の部位において相互に接続固定される。

上記の側壁151Zの内面と梁部157Zaとの間には間隙が設けられる。これによって、流通開口部150Bを通して内部空間150A内に導入された気体原料がフィルタ部材153Zを通過した後において、梁部157Zaに妨げられずに供給ラインに送出されるように構成される。

上記伝熱枠157Zの内部には加熱手段157Hが導入され、加熱手段157Hは、梁部157Zaの内部を通過する。 図示例では、ワイヤ状の加熱手段157Hが複数の梁部15 7Zaを順次蛇行状に通過するように構成される。もちろん、 複数の加熱手段157Hを夫々の梁部157Zaを挿通する ように構成してもよく、各梁部157Zaの内部に夫々加熱 手段を内蔵してもよい。

伝熱枠157Zの内部、特に梁部157Zaの内部には、温度センサ157TCの温度検出点が配置される。そして、温度制御回路CONTは、温度センサ157TCの検出温度に基づいて、上記の加熱手段157Hの発熱量を制御する。これによって、側壁151Zとは別に、独立して伝熱枠157Zの温度制御を行うことができる。このように、温度センサ157TCにより伝熱部157Zaの温度を検出して加熱手段157Hが制御されることから、遮蔽板154Zの温度低下をの制御性が向上する。従って、遮蔽板154Zの温度低下を

46

低減することができる。この場合、加熱手段157Hの設定 温度は気化室に対する設定温度と同一とすることが好ましい。

なお、この実施形態において、上記の梁部157Zaそのものを、ロッド状ヒータなどの加熱手段で構成してもよい。 伝熱枠157の外枠部内に加熱手段を配置するように構成してもよい。

以上のように、伝熱部を梁状に構成してもよく、また、この伝熱部の内部に加熱手段を配置してもよく、更には、伝熱部自体を加熱手段としてもよい。

## < 第 1 0 実 施 形 態 >

図11A、Bは、本発明の第10実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図11A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部170を示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。

この送出部170は、側壁171の内側に加熱機能を有する板部材172が内側から嵌合固定された構造を有する。板部材172の内端面172aは気化室に臨み、上記の遮蔽板と同様の機能を有する。そして、内端面172aとその周囲の側壁171との間に設けられた間隙が流通開口部170Bとなっている。板部材172には、その内端面172aの反対側にある、側壁171に対向する部分に複数の柱状の伝熱部172pが配設される。これらの伝熱部172pは側壁171の内面に熱接触する。

板部材172の内部にはヒータなどの加熱部172Hと、

4 7

温度センサ172TCの温度検出部が配置される。板部材172の一部は側壁171の外側に突出し、ここに、加熱部172Hに接続された給電端子172e及び温度センサ172TCの検出端子172fが配設される。送出部170の内部空間170Aは、側壁171と板部材172によって囲まれた領域であり、送出路170Sに連通する。内部空間170Aは環状(リング状)に構成される。

内部空間170Aには、多数の伝熱部172pが、原料ガスの流れ方向に対して略直交して分散配置されており、これらの伝熱部172pによってフィルタと同様の機能、即ち、気化室から進入してきた残留ミストやパーティクルを捕捉する機能を有するように構成される。これらの伝熱部172pは、側壁171の内面と、遮蔽板と同様の機能を有する内端を目れる。これによって、機能となっている。これによって、機留172pに接触して気化し、気化効率が向上すると共に、パーティクルの発生が抑制される。」でき、これにより、残留ミストやパーティクル等の固形物を除去することができる。

即ち、気化室110(図1参照)に面する板部材172の表面は、気化室110の他の内面と同様に、液体原料を気化させる気化面として機能する。また、板部材172が送出路170Sへの送出口(ガス出口)170SOを覆うように配設され、板部材172と送出路170Sとの間に、気化室1

48

10と送出口170SOとを接続するガス通路部が形成される。このガス通路部で、伝熱部172pの熱伝導柱が流体バッフルとして機能し、これがフィルタの機能を代替する。

本実施形態においても、上記の伝熱部172pは、気化室側から流通開口部170Bに進入する全ての仮想直線が伝熱部172pを通過することなしにそのまま送出路170Sに到達するといったことのないように配置される。複数の内の流部172pは、これらが配置される内部空間170A内の流通開口部170B側(図示外周側)から送出路170S側(内周側)に向けて伝熱部172pを通過しない仮観まれるのほとんどが少なくとも1回は伝熱部172pに接触して、のほとんどが少なくとも1回は伝熱部172pに接触したから送出路170Sに進入するように構成される。このためい気体原料の流通を確保しながら、パーティクルの排出を防止し、しかも残留ミストの気化作用を促進することができる。更に、フィルタ部材を用いていないので、目詰まりによる気化室内の圧力上昇がなくなり、長期使用が可能となる。

板部材172の温度制御は、温度制御回路CONTによって、温度センサ172TCの検出温度に基づいて、気化室の温度制御とは独立して行われる。従って、遮蔽板に相当する内端面172aの温度低下を低減することができる。この場合、板部材172の設定温度は気化室に対する加熱手段の設定温度と同一とすることが好ましい。なお、側壁171の内部にも別の加熱手段を設けても構わない。

< 第 1 1 実 施 形 態 >

図12A、Bは、本発明の第11実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図12A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部170′を示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。送出部170′のうち、第10実施形態と同様の部分には同一符号を付して示す。

この実施形態では、側壁171′に対して内側から板部材 172′が嵌合固定された構造を有する。板部材172′の 内端面172aと、その周囲の側壁171′との間には流通 開口部170B′が形成される。側壁171′と板部材17 2′との間に上記流通開口部170B′に連通する環状(リング状)の内部空間170A′が設けられ、送出路170 S′にも連通する。

この実施形態において、内部空間170A′内には、環状に構成されたフィルタ部材173が配置される。フィルタ部材173の外縁部は、側壁171′の内面に対して固定される。フィルタ部材173の外縁部以外の部位が、側壁171′から突出した柱状の伝熱部171p′及び板部材172′から突出した柱状の伝熱部172p′に熱接触する。具体的には、伝熱部171p′と172p′によってフィルタ部材173が挟持された状態となっている。

この実施形態では、側壁171′の内部(収容孔171 a′)にも別の加熱手段172″が配置される。従って、フィルタ部材173は、板部材172′の加熱部172Hと加熱手段172″の双方から伝熱部171p′及び172p′ を夫々介して熱を受けるように構成される。従って、フィルタ部材173は、これらの伝熱部を介してより大きな熱量を受けることができる。この場合、効率よく気化を行うと共に、 残留ミストやパーティクル等の固形物をフィルタ部材により 除去することができる。

### < 第 1 2 実 施 形 態 >

図13A、Bは、本発明の第12実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図13A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部180を示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。

この実施形態において、側壁181には複数の加熱手段182が外側から挿入された状態で取り付けられる。これらの加熱手段182の先端には、側壁181の内面から突出する柱状の伝熱部185が夫々接合される。

送出路180 Sに連通するように構成された、側壁181 の内部に画成された内部空間180 Aには、内側(気化室 側)に開いた容器状のフィルタ部材183が配置される。フィルタ部材183は、その外縁部が固定ねじ188等により 側壁181の内面に固定される。フィルタ部材183の外縁 部以外の部分は、側壁181に設けられた柱状の支持突起1 81 c や上記の伝熱部185に熱接触する。

内部空間180Aの気化室に臨む位置(フィルタ部材18 3の更に内側)には遮蔽板184が配置される。遮蔽板18 4は、フィルタ部材183に対してスペーサ186を介して 熟接触した状態となっており、固定ねじ186aによって伝熱部185に対して固定される。遮蔽板184と、その周囲にある側壁181の部分との間には間隙が設けられ、この間隙が流通開口部180Bとなっている。

この実施形態では、フィルタ部材183が軸線方向を深さ方向とする容器形状に構成される。このため、フィルタ部材183には軸線方向に伸びる側面部分も存在することから、そのフィルタ面積を大きくすることができる。その結果、フィルタ部材183の寿命を延ばすことができる。熱伝導柱を構成する上記の伝熱部185、スペーサ186及び固定ねじ186aは、加熱手段182に直接熱接触する。このため、効率的にフィルタ部材183や遮蔽板184を加熱することができる。

## <第13実施形態>

図14A、Bは、本発明の第13実施形態に係る気化器の主要部を示す概略内部側面図及び概略縦断面図である。図14A、Bは、図1に示す気化器の送出部130の代わりに用いることのできる送出部190を示すものであり、その他の部分は第1実施形態と同様である。

この実施形態において、側壁191の内部(収容孔191 a)には加熱手段192が配置される。側壁191には、内側(気化室側)に開いた内部空間190Aが構成され、これ は送出路190Sに連通する。

内部空間190Aにはフィルタ部材193が配置され、その外縁部が固定ねじ198等により側壁191に固定される。

フィルタ部材193の外縁部以外の部位は、側壁191の内面から突出した柱状の複数の伝熱部197に熱接触する。フィルタ部材193の内側には、気化室に臨む遮蔽板194がスペーサ196を介して固定ねじ196aにより伝熱部197に固定される。遮蔽板194の周囲には、側壁191との間に間隙が設けられ、この間隙が流通開口部190Bとなる。遮蔽板194とフィルタ部材193の全面に亘って空間部190Dが形成される。

側壁191には穴191bが設けられ、穴191b内に温度センサ199が配置される。温度センサ199の温度検出点は上記伝熱部197の近傍若しくはその内部に配置される。

この実施形態では、フィルタ部材193の内部に加熱手段193Hが配置される。具体的には、加熱手段193Hはワイヤ状のヒータであり、これがフィルタ部材193の内部を蛇行状に通過する。フィルタ部材193の内部には温度センサ193TCもまた配置される。そして、温度制御回路CONTによって、温度センサ193TCの検出温度に基づいて、加熱手段193Hの発熱量が制御され、フィルタ部材193が直接独立して温度制御されるように構成される。

この実施形態では、フィルタ部材193の内部に加熱手段193Hが配置されるので、フィルタ部材193が直接加熱されると共に、フィルタ部材193を独立して温度制御することができる。従って、フィルタ部材193の温度を精密に制御できると共に、その温度の均一性を高めることができる。このため、フィルタ部材193の目詰まりや堆積物の局部集

中を抑制することができ、気化室内の圧力上昇を抑制すると 共に、フィルタ寿命を延ばすことができる。

# <第14実施形態>

図15は、本発明の第14実施形態に係る気化器を示す概 略縦断面図である。図16は、図15のA-A線に沿った第 14実施形態の気化器を示す横断面図である。この実施形態 の気化器は、上記第1実施形態と同様の気化面210B及び 気化空間210Aを構成する気化室210を有する。気化空 間210Aに液体原料を噴霧するため、噴霧手段120が配 設 さ れ る 。 気 化 室 2 1 0 に 対 し て 、 第 2 気 化 部 に 相 当 す る 送 出部220が着脱可能に取り付けられる。ここで、上記噴霧 手段120の構成(原料供給管121、噴霧用ガス供給管1 22及び噴霧ノズル123)、気化室210の側壁211及 び加熱手段212は、上記第1実施形態と同様である。送出 部220において、側壁221、加熱手段222、フィルタ 部材223、遮蔽板224、伝熱部225、スペーサ226 及び固定ねじ226 a は第1実施形態と同様の機能を有する。 送出部220に設けられた内部空間220A、遮蔽板224 の周囲に設けられた流通開口部22B、送出路220Sにつ いても第1実施形態と同様である。

本実施形態において、気化室210は、図16に示すように噴霧ノズル123の軸線周りに湾曲した内面形状を有する。 具体的には、気化室210は円筒状に構成される。ここで、 気化室210の形状は、噴霧ノズル123の軸線を中心とし た円錐形、或いは、噴霧ノズル123の軸線を直径の一つと

5 4

する球形であっても構わない。そして、上記のフィルタ部材223及び遮蔽板224は、上記のように噴霧ノズル123の軸線周りに湾曲した内面に沿った湾曲形状を有する。ここで、フィルタ部材223の外縁部は固定ねじ228等によって側壁221に固定される。フィルタ部材223と遮蔽板224との間には空間部220Dが形成される。

上記のように、本実施形態では、遮蔽板224が気化室2 . 10の内面形状に沿った形状を有する。このため、フィルタ 面積を大きく確保することができると共に、気化器をコンパ クトに 構 成 で き る 。 本 実 施 形 態 で は ま た 、 気 化 室 2 1 0 内 の ミストや気体原料の流れが送出部220の存在によって影響 を受けにくくなるように構成してある。図示例では気化室2 1 0 は、噴霧ノズル 1 2 3 の軸線周り全体にほぼ均等な形状 (回転体形状)となる。これによって、気化室210内の温 度分布や気化面210B及び遮蔽板224の内面の温度分布 を安定させることができる。このため、特定部位への固形物 の集中的な堆積を防止することが可能になる。フィルタ部材 2 2 3 を 遮 蔽 板 2 2 4 に 沿 っ た 面 形 状 を 有 す る も の と す る こ とで、フィルタ部材 2 2 3 と遮蔽板 2 2 4 との間隔を一定に 構成することができる。このため、フィルタ部材223の全 面を有効に用いて、残留ミストや固形物を効率的に捕捉する ことが可能になる。

本実施形態では、上記のように気化室210が噴霧ノズル 123の軸線周りに湾曲した内面を有する形状となっている が、気化室の形状については何等限定されない。従って、気 化室の形状は、立方体(6 面体)などの多面体形状であっても構わない。この場合、上記遮蔽板及び/又はフィルタ部材は、上記と同様に、多面体形状の一部を構成するように気化室の内面に沿った形状とすることが好ましい。この場合、遮蔽板及び/又はフィルタ部材が上記多面体形状のうちの2面以上を構成するように形成されていてもよい。更に、気化室は、曲面と平坦面とが組み合わされた内面形状を備えていてもよい。

本実施形態では、第1実施形態と同様に、圧力が一ジ(図示せず)を取り付ける検出用配管219に連通する開口が気化室210Aに臨むように形成される。そして、この開口部に対力を取材213と、フィルタ部材213と、フィルタ部材213は、側壁214とが配設される。フィルタ部材213は、側壁2110の内面から突出するるを介して出当接する。伝熱部215は、スペーサ216を介して出たのスペーサ216及び固定ねじ216aを介してこれらのスペーサ216及び固定ねじ216aが設けられ、この開口部を通して気化室210Aに対けられ、この開口部を通して気化室210Aに対ける。また、の開口部材213を通して検出用配管219の内部に連通する。

上記の遮蔽板214は、気化室210Aから侵入する残留 ミストや固形物がフィルタ部材213に到達しにくくなるよ うにする。このため、フィルタ部材213の目詰まりが緩和 され、フィルタ部材 2 1 3 の長寿命化を図ることができる。フィルタ部材 2 1 3 及び遮蔽板 2 1 4 は伝熱部 2 1 5 を介してその外縁部以外の部分において熱的に側壁 2 1 1 と熱的に接触する。このため、気化室 2 1 0 A の内面とほぼ同様に加熱されることから、残留ミストが付着したとき、当該残留ミストを気化させることができる。

## < 第 1 5 実施形態 >

図17Aは、本発明の第15実施形態に係る気化器を示す 概略縦断面図である。ここで、送出部230以外の構成は図 1に示す実施形態と同様であるものとする。送出部230は、 側壁231と、側壁231と気化空間110Aとの間に配置 されるハニカム状のフィルタ部材232と、フィルタ部材2 32の内部に配置されたヒータなどの加熱手段233とを有 する。側壁231には、供給ラインに気体原料を送出する気 体原料送出路231aが形成される。ここで、フィルタ部材 232を通過した後のガスの温度低下を防止するために、側 壁231を加熱するための加熱手段を別途設けてもよい。こ の加熱手段は、側壁231の内部や外面上などに設けること ができる。

フィルタ部材 2 3 2 は、熱伝導性の良好な金属(例えばステンレス鋼など)又は A 1 N、S i C等のセラミックなどで構成された板状材で構成される。フィルタ部材 2 3 2 の内部には、気体原料の流路方向(図示右方向)と交差する(図示例では直交する)方向に収容孔(或いは収容穴、以下同様)2 3 2 a が形成される。収容孔 2 3 2 a には上記加熱手段 2

3 3 が収容される。ここで、加熱手段233はフィルタ部材232の内部全体に亘って配置されていてもよい。この場合には更に熱効率を高めることができる。フィルタ部材232には、気体原料の流路方向とほぼ平行に貫通した微小な細孔232bが多数形成される。なお、細孔232bは、残留ミストや固形物がフィルタ部材にあたって再気化するように、原料ガスの流れ方向に対して略直交して形成してもよい。

これらの細孔 2 3 2 b は、その貫通距離(長さ)が直径に較べて大きい形状となるように構成される。細孔 2 3 2 b の長さ(図示例ではフィルタ部材 2 3 2 の厚さに一致する。)は、気化空間 1 1 0 Aにて発生した微小な残留ミストの捕捉率が充分に高くなるように設計される。具体的には、細孔 2 3 2 b の直径は 0 . 0 1 ~ 1 . 0 mm程度、貫通距離は 5 ~ 1 5 mm程度である。

なお、加熱手段233を収容する収容孔232aと、一部の細孔232bとが交差するように構成されていてもよい。 或いは、収容孔232aと交差する位置には、細孔232b が形成されていないように構成されていてもよい。

### < 第 1 6 実 施 形 態 >

図17Bは、本発明の第16実施形態に係る気化器を示す概略縦断面図である。この第16実施形態では、側壁231と、ハニカム状のフィルタ部材232との間に、フィルタ部材234が配置される。フィルタ部材234は、側壁231に対して固定部材235によって接続固定される。フィルタ部材232とフィルタ部材234との間には、これらのフィ

5 8

ルタ面全体に亘って空間部 2 3 0 D が形成される。これら以外の点、即ち、フィルタ部材 2 3 2 及び加熱手段 2 3 3 については、図 1 7 A に示す第 1 5 実施形態と同様である。

この構成例では、ハニカム状のフィルタ部材232の下流 側にフィルタ部材234が配置されることにより、供給ライ ンに導入されるミストやパーティクルの量を更に低減するこ とができるという効果が得られる。なお、フィルタ部材23 4は、フィルタ部材234よりも細かい残留ミストを捕捉で きるように構成されることが望ましい。例えば、第1実施形 態に示すフィルタ部材133と同様のものを用いることがで きる。図示例では、フィルタ部材234は、側壁231を介 して、或いは、フィルタ部材232からの輻射熱によって間 接的に加熱される。フィルタ部材234には、図1に示す実 施形態のフィルタ部材133と同様に伝熱部235(スペー サ)を介して加熱手段の熱が伝達される。なお、フィルタ部 材234を伝熱部235及び側壁231に固定する固定手段 235aが用いられる。ここで、第15実施形態のフィルタ 部材232と同様にその内部に加熱手段を配置してもよい。 側壁231内に加熱手段を設けてもよい。いずれの場合にお いても、この加熱されたフィルタ部材234は、気化室の気 化面(内面)と同一温度に制御されることが好ましい。

この実施形態では、フィルタ部材232によって比較的大きな残留ミストを捕捉して気化させることができ、フィルタ部材234によって比較的小さな残留ミストを捕捉するように構成される。従って、ミストの除去効率を高めることがで

5 9

きると共に、各フィルタ部材232、234の目詰まりを低減することができる。

## <第17実施形態>

図18Aは、本発明の第17実施形態に係る気化器を示す概略縦断面図である。この第17実施形態においても、送出部330以外の構造は上記第1実施形態と同様である。

この実施形態では、送出部330には、外壁331と、外壁331の内側において気化空間110Aに臨む内壁332とを有する。外壁331には、気体原料送出路331aが形成される。内壁332には、気化空間110Aと、送出部330の内部空間330Aとを連通させる連通孔332aが形成される。内壁332の内部には、ヒータなどの加熱手段33が配置される。

内部空間 3 3 0 A は、外壁 3 3 1 と内壁 3 3 2 によって画成される。内部空間 3 3 0 A には、フィルタ部材 3 3 4 が配置される。フィルタ部材 3 3 4 は、その外縁部以外の部位において伝熱部 3 3 5 を介して熱接触した状態にある。伝熱部 3 3 5 は、加熱部材 3 3 4 により発生した熱を内壁 3 3 2 から受けてフィルタ部材 3 3 4 は、伝熱部 3 3 5 を介して内壁 3 3 2 に夫々接続固定される。より具体的には、固定手段 3 3 5 a によってフィルタ部材 3 3 4 は伝熱部 3 3 5 な 及び内壁 3 3 2 に固定される。即ち、伝熱部 3 3 5 は、フィルタ部材 3 3 4 を支持する支持部材としても機能する。

この実施形態では、気化空間110Aで生成された気体原

料が連通孔332aを通して内部空間330Aに導入される。内部空間330Aに導入された気体原料は、フィルタ部材334を通過して、気体原料送出路331aから送出される。ここで、フィルタ部材334は、伝熱部335を介して加熱手段333により加熱されるため、気体原料中に存在する微細な残留ミストが付着しても、確実に気化させることができる。図示例では、フィルタ部材334には、複数の伝熱部335が外縁部以外の分散配置された部位に熱接触する。このため、フィルタ部材334全体がより均一に加熱されることにより、温度のばらつきが少なくなり、局部的な目詰まりなどを防止できる。この場合においても、この加熱されたフィルタ部材334は、気化室の気化面(内面)と同一温度に制御されることが好ましい。

この実施形態では、送出部330の内壁332が気化室110の気化空間110Aに臨むように配置される。しかも、内壁332の内部に加熱手段333が配置されるので、加熱手段333は、気化空間110A内の原料の気化作用にも寄与するものとなっている。

なお、内壁 3 3 2 に設けられた上記連通孔 3 3 2 a は、噴霧手段(噴霧ノズル:図示せず)側に偏った位置に形成される。これによって、気化空間 1 1 0 A 内に噴霧されたミストが直接連通孔 3 3 2 a を通ってフィルタ部材 3 3 4 に捕捉されるといったことが低減される。

## <第18実施形態>

図18日は、本発明の第18実施形態に係る気化器を示す

概略縦断面図である。この実施形態の送出部430では、側壁431の内部に加熱手段432が収容配置される。そして、側壁431の内側に、フィルタ部材433が配置される。フィルタ部材433は、その外縁部以外の部位が側壁431に突出して形成した伝熱部434(スペーサ)に熱接触した状態にある。伝熱部434は、フィルタ部材433と側壁431とに夫々接続固定される。より具体的には、固定手段431とに大々接続固定される。より具体的には、固定手段431に固定される。即ち、伝熱部434は、フィルタ部材433を支持する支持部材としても機能する。この場合においても、この加熱されたフィルタ部材434は、気化室の気化面(内面)と同一温度に制御されることが好ましい。

### < 第 1 9 実 施 形 態 >

図19は、本発明の第19実施形態に係る気化器を示す概略縦断面図である。この実施形態の気化器500は、原料気化部510と、噴霧手段520と、送出部530とを有する。原料気化部510は、側壁511と、側壁510の内面を形成する気化面511Aとその内部に配置されたヒータなどの加熱手段512とを有する。噴霧手段520には、原料供給管521と、噴霧用ガス供給管522と、噴霧ノズル523とが配設される。

噴霧ノズル523は、原料を噴霧用ガスの圧力で噴霧する ものである。噴霧ノズル523では、その内部に原料と噴霧 用ガスとが夫々導入され、その原料が複数(図示例では3 つ)の噴霧口523aから噴霧用ガスにより噴霧されるよう に構成される。より具体的には、導入された原料は原料拡散室523sを介して複数の原料供給路523vに分流される。これらの原料供給路523tを介して原料供給路523tを介して原料供給路523tを介して原料供給路523vに同軸に形成された経路に分流され、各原料供給路523vにより供給された原料を噴霧口523aによって、解料供給路523vにより供給された原料を噴霧口523aによって、原料供給量を増やしてミスト量を増大させることができる。また、噴霧量を増やしてミスト量を増大させることができるようになる。従って、原料の気化効率を高めることができると共に、残留ミストやパーティクルを低減できる。

なお、図示例では、噴霧ノズル523に原料を供給する原料供給管521は一本だけ描かれているが、必要に応じて複数の原料供給管521を設けることができる。この場合、複数の原料供給管521により供給される複数種類の原料を噴霧ノズル523内で噴霧直前にて混合し、この混合物を噴霧用ガスと共に複数の噴霧口523aにて分担して噴霧(マトリクス噴霧)する。

上記の噴霧ノズル 5 2 3 の噴霧方向に配置される上記側壁 5 1 1 の内面である気化面 5 1 1 Aは、略球面(半球)状に 構成される。これによって、噴霧口 5 2 3 a から気化面 5 1 1 Aまでの距離がミストの噴霧方向にかかわらずほぼ一定に なる。当該気化面 5 1 1 Aに吹き付けられるミスト量が球面上においてほぼ均一化されるなどの理由により、噴霧ノズル

WO 2004/100249

5 2 3 から噴霧されたミストを効率的に気化させることがで きる。

本実施形態の送出部530においては、側壁531と、側壁531と、側壁531の内側に配置されたハニカム状のフィルタ部材53 2とが配設される。側壁531には、気体原料送出路531 aが形成される。フィルタ部材532には、気体原料の流路 方向と交差する方向に形成された収容孔(又は収容穴、以下同様)532aが設けられる。なお、収容孔532aは、残留ミストや固形物がフィルタ部材にあたって再気化するよい。収容孔532aにはヒータなどで構成される加熱手段533が外周側に配置される。フィルタ部材532には、気体原料の流路方向に貫通した多数の細孔532bが形成される。これらの細孔532bは、気化空間510Aと、送出部530の内部空間530Aとを連通する。

本実施形態において、フィルタ部材 5 3 2 は、気化空間 5 1 0 Aに対して噴霧ノズル 5 2 3 側に配設され、る。より具体的には、気化面 5 1 1 Aと対向して噴霧ノズル 5 2 3 を取り囲むように、噴霧ノズル 5 2 3 の周囲にフィルタ部材 5 3 2 が配置される。噴霧ノズル 5 2 3 の噴霧方向とは反対側(背後)に送出部 5 3 0 の内部空間 5 3 0 Aが画成される。また、気体原料送出路 5 3 1 a は更にその背後に形成される。このように構成されることによって、噴霧ノズル 5 2 3 から噴霧されたミストが直接にフィルタ部材 5 2 3 に付着することが防止される。この場合、第 1 実施形態のように遮蔽板 1 3 4

を設ける必要もない。

フィルタ部材 5 3 2 は、その内部に配置された加熱手段 5 3 3 によってほぼ一様に加熱される。従って、気化面 5 1 1 Aによって気化空間 5 1 0 A内に生成された気体原料と共に流れる微細な残留ミストは、フィルタ部材 5 3 2 に付着し、ここで再気化される。気体原料は細孔 5 3 2 b を通過して内部空間 5 3 0 A に導かれ、最終的に気体原料送出路 5 3 1 a を通過して送出されていく。フィルタ部材 5 3 2 に形成される細孔 5 3 2 b は、第 2 実施形態と同様にその寸法が設計される。

本実施形態において、内部空間 5 3 0 A (フィルタ部材 5 3 2 と気体原料送出路 5 3 1 a との間)に、図示破線で示すフィルタ部材 5 3 4 を設けることが好ましい。フィルタ部材 5 3 4 は、第 1 実施形態或いは第 1 5 実施形態のフィルタ部材 5 3 4 は、第 1 実施形態或いは第 1 5 実施形態のフィルタ部材 5 3 4 なができる。第 1 実施形態と同様に、フィルタ部材 5 3 4 の外縁部以外の部位を熱接触して側壁 5 3 1 より突出して形成される伝熱部に固定が好ましい。この場合、この伝熱部は、フィルタ部材 5 3 2 からフィルタ部材 5 3 4 に熱を伝えるように構成される。なお、加熱手段を側壁 5 3 1 に内蔵し、側壁 5 3 1 に対して伝熱部を取り付け、この伝熱部をフィルタ部材 5 3 4 に熱接触させるようにしてもよい。

図20A、Bは、噴霧手段の変更例を示す概略正面図及び 概略側面図である。この噴霧手段620には、複数(図示例 では3つ)の原料供給管621と、噴霧用ガス供給管622 と、噴霧ノズル623とが配設される。これらの複数の原料供給管621から供給される各原料は、夫々個々に噴霧ノズル623内で事前に混合され、複数の噴霧口623aの夫々から夫々に対応する噴霧用ガスと共に噴霧されるように構成される。この構成は、例えば、3種の気体原料(Pb、Zr及びTiの誘導体(有機金属化合物))を供給してPZT(チタン酸ジルコン酸鉛)を形成する場合に適用される。この場合、これら3種の原料を上記噴霧手段620に導入することによって、夫々の原料が個々に噴霧ノズル623内で混合される。そして、3種の原料は、夫々の専用の噴霧口623aから夫々の噴霧口623aに対応する噴霧用ガスと共に噴霧される。

噴霧手段620においては、上記第19実施形態の噴霧手段520と同様の効果を有する。更に、原料毎に専用の噴霧口623aが形成されることにより、原料別に噴霧態様(原料の噴霧量、混合する噴霧用ガスの量、噴霧圧力など)を調整することができるといった利点を有する。

図20C、Dは、噴霧手段の別の変更例を示す概略正面図及び概略側面図である。この噴霧手段720には、複数の原料供給管721と、噴霧用ガス供給管722と、噴霧ノズル723とが配設される。噴霧ノズル23には、複数の原料供給管721に対応して連通する気体原料導入ブロック723B~Dが配設される。複数の原料供給管721から夫々供給される原料は、噴霧ノズル723の内部において気体原料導入プロック723D、723C、723Bにおいて順次に噴

霧口723aに連通する管路に導入されて混合される。そして、複数の原料は、噴霧用ガス拡散室723Aを介して同軸に導入された噴霧用ガスと共に噴霧口723aから噴霧される。

噴霧手段720においては、複数種類の原料を均一に混合することができる。このため、気化空間内において混合原料が気化されて成膜室内に供給されることにより、膜の組成比の再現性が向上するといった効果を有する。

図21は、本発明の実施形態に係る反応処理装置(半導体処理装置)を示す概略構成図である。この反応処理装置は、例えば、気体原料を用いて薄膜を形成するためのCVD装置である。この反応処理装置は、原料供給部200と、原料供給部200により供給された原料を気化する気化器100(500)と、気化器により生成された気体原料を用いて処理を行う反応処理部300とを有する。

図22は、原料供給部200の内部構成を示す概略構成図である。原料供給部200には、原料A~Cを収容する原料容器202A~202Cが設けられ、原料容器202A~202Cから送液ライン204A~204Cを通して原料A~Cが気化器100(500)へと制御された流量で供給される。原料容器202A~202Cには、例えば、短導体装置の材料として、強誘電体薄膜を成膜するのであればPb、Zr、Ti(PZT)やPb、Zr、Ti、Nb(PZTN)、高誘電体薄膜を成膜するのであればBa、Sr、Tiなどの有機金属化合物が、更に超伝導薄膜を成膜するのであればB

i、Sr、Cuなどが夫々用いられる。ここで、原料及び原料容器の数は図示例には限定されず必要に応じて任意数設置される。溶剤容器202Dが設けられ、この容器内に用意された溶剤が送液ライン204Dを通して供給される。更に、各原料容器202A~202C及び溶剤容器202Dの各送液ライン204A~204Dに接続されたドレインライン203が設けられ、ドレインライン203に接続されたドレイン容器202Eが配設される。

送液ライン204A~204Dは、一端を各原料容器202A~202C及び溶剤容器202Dの液中に浸漬する位置に配設される。夫々下流側に伸びる途中に流体流量調節手段(例えばマスフローメータなどの流量制御計)205A~205Dが配設される。送液ライン204A~204Dは、流体流量調節手段から更に下流側に伸びて、気化器100(500)に各原料を送液する。流体流量調節手段205A~205Dは、夫々コントローラ(図示せず)から制御信号を受けて流量を調整する。

原料供給部200は、不活性ガスなどを導入するガス導入ライン206から分岐したガス供給ライン206A~206 Dによるガス供給ライン206 A~206 Dによるガス供給により生じた圧力によって原料A~C及び溶剤を夫々の送液ライン204A~204 Dに送出する。溶剤を供給する送液ライン204 Dと、原料を供給する各送液ライン202 A~202 C及びガス供給ライン206 A~206 Cとの間には溶剤供給ライン207 が接続される。更に、排気装置

(図示せず)に接続されたバキュームライン208がドレイン容器202Eに接続される。

ガス供給ライン206A~206Dには逆止弁CHが介挿され、また、全てのラインには図示のように適所に開閉弁DV(ダイヤフラムバルブ)が介挿される。更に、原料供給ラインの液体流量調整手段205A~205Dの上流位置にはセパレータ(脱気器:図示せず)が介挿されることが好ましい。

再び図21に戻り、気化器100(500)においては、 気化室110(510)において気化された原料が、送出部 130(150、150′、150″、160、160′、 150X、150Y、150Z、170、170′、180、 190、230、330、430、530)を介して原料供 給ライン140に送出される。

6 9

設されるのに対して、再気化フィルタ142は、上記の送出部と同じ構成を有するにも拘らず、気化器とは別体に配設される点で異なる。ここで、気化原料の供給構造としては、上記送出部と、再気化フィルタ142とは、いずれか一方のみが設けられていても構わない。

処理部300には、半導体ウエハなどの被処理基板を載置するため、サセプタ304が配設された反応室301を有する。反応室301内で、サセプタ304に対向して、ガス導入部(シャワーヘッド)303が配設される。シャワーへッド303からは、気化器100(500)から供給された気体原料(適宜のキャリアガスと共に導入される)が反応室301内に導入される。シャワーヘッド303からはまた、別途のガス導入管305から供給された反応ガス(例えば酸素ガスなどの酸化性ガス)が反応室301内に導入される。反応室301には、反応室301内を排気するため、排気管306が接続される。

上記の反応処理装置においては、気化器の送出部(130、150、150′、150″、160、160′、150Х、150又、170′、180、190、230、330、430、530)又は再気化フィルタ142によって反応室301に導入されるミストやパーティクルの量を大幅に低減することができる。このため、反応室301内にて行われる処理(例えば成膜処理)の品位を高めることができる。上記送出部や再気化フィルタにおいては、その内部に配置されるフィルタ部材がより均一に加熱されること

によって、気化効率が高められ、目詰まりが防止される。このため、供給ラインのコンダクタンスを維持しつつ、メンテナンス頻度を低減できる。

図23は、本発明の別の実施形態に係る反応処理装置(半 導体処理装置)を示す概略構成図である。この構成例では、 原料供給部200から気化器100(500)に原料が供給 され、気化器100(500)から原料供給経路141に気 体原料が供給され、処理部300に供給される点では上記と 同様である。ただし、原料供給経路141にはArガスなど の不活性ガスを供給するパージライン145が導入される点 で異なる。この構成例では、再気化フィルタ142及び排気 経路143は設けられていない。

この構成例では、気化器100(500)から反応室30 1までの距離(原料供給経路141の長さ)が可能な限り短くすることで、原料供給経路内の在留気化ガス量を小さくする。これにより、原料供給系におけるパーティクルの発生を抑止することができることから、反応室301で成膜される膜の品位を向上させることができる。

図24は、気化室の内圧の時間的変化(内圧の原料供給時間依存性)について、第2実施形態の気化器と従来の気化器 (単にフィルタ部材を従来の態様で設置したもの)とで比較 して示すグラフである。

従来の気化器では、線L2で示すように、原料供給時間が 100時間に達する前に上限圧力を越えた。このため、加熱 しながらN2などの不活性ガスを流すパージ処理を行って一 WO 2004/100249 PCT/JP2004/006609

7 1

時的に内圧を低下させたが、その後短時間のうちに再び上限 圧力を超えた(なお、図ではパージ処理期間を省略して示 す)。これは、フィルタ部材に固形物が大量に付着し、コン ダクタンスを低下させたためと思われる。

これに対して、第2実施形態の気化器では、線L1で示すように、原料供給時間が600時間を越えても上限圧力にははるかに届かず、従来構造の場合に較べてコンダクタンスの低下が大幅に抑制されることがわかった。なお、第2実施形態では、上記のようにコンダクタンスの低下がほとんど発生していないが、フィルタ部材が機能していないわけではない。第2実施形態では、却って従来構造に較べて反応室に流れるパーティクルの量が半分以下に低減されることが実験的に確かめられた。

特に、従来構造の場合には下流側に接続されたインラインフィルタによって反応室に流れるパーティクル量が大きく減少するが、第2実施形態の場合には、下流側に接続されたインラインフィルタを取り外しても、反応室に到達するパーティクルの量がほとんど変化しないことが判明した。このことは、インラインフィルタの有無による変化がほとんど現れない程度に第2実施形態の気化器において発生するパーティクルの量が少ないことを示すと思われる。

このため、図24に示す内圧変化の測定では、原料供給時間が約170時間となった時点(図示点線)で、下流側に接続されたインラインフィルタを取り外して測定を継続して行った。その結果、グラフの内圧値は170時間以降において

はやや低下した。このように、第2実施形態では、フィルタ 部材の詰まりによるコンダクタンスの低下が大幅に抑制され ると共に、下流側へ流れるパーティクルを格段に低減するこ とができることが実証された。

なお、本発明の気化原料の供給構造、気化器及び反応処理 装置は、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発 明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例えば、上記の実施形態のいずれかに示し た側壁、内部空間、加熱手段、フィルタ部材、遮蔽板、伝熱 部(熱伝導柱)、流通開口部の夫々の特徴点は、夫々独立し て他の実施形態にも適用可能であり、夫々の実施形態に示す 他の構成との組合せに限定されるものではない。

#### 産業上の利用可能性

本発明によれば、気体原料中のミスト及びパーティクルを低減できる気化器を提供することができる。

WO 2004/100249



73

### 請 求 の 範 囲

1. 気化器であって、

液体原料を気化させて気体原料を形成する気化室と、

前記気化室に前記液体原料を噴霧する噴霧部と、

前記気化室からガス出口へ前記気体原料を送出する送出部と、

前記気化器を加熱する加熱部と、

を具備し、前記送出部は、

前記気体原料を通過させるように前記ガス出口を覆うフィルタ部材と、

前記加熱部の熱を前記フィルタ部材に伝達する伝熱部材と、を具備する。

2. 請求の範囲1に記載の気化器において、

前記伝熱部材若しくは前記フィルタ部材の温度に基づいて前記加熱部の温度制御を行う制御部材を更に具備する。

- 3. 請求の範囲1に記載の気化器において、
- 前記伝熱部材は、複数の伝熱部材を具備する。
- 4. 請求の範囲1に記載の気化器において、

前記伝熱部材に組み込まれたヒータを更に具備する。

5. 請求の範囲1に記載の気化器において、

前記伝熱部材は前記フィルタ部材の外縁部以外の部位に熱接触する。

6. 気化器であって、

液体原料を気化させて気体原料を形成する気化室と、

前記気化室に前記液体原料を噴霧する噴霧部と、

前記気化室からガス出口へ前記気体原料を送出する送出部と、

前記気化器を加熱する加熱部と、

を具備し、前記送出部は、

前記気体原料を通過させるように前記ガス出口を覆うフィルタ部材と、

前記ガス出口と反対側で前記フィルタ部材を被覆する遮蔽板と、

を具備する。

7. 請求の範囲5に記載の気化器において、

前記遮蔽板は、前記気化室から前記ガス出口に導入される前記気体原料の仮想直線が前記フィルタ部材に直接到達しないように配設される。

8.請求の範囲5に記載の気化器において、

前記フィルタ部材と前記遮蔽板との間に、前記気体原料を前記ガス出口へ送出する加熱されたガス通路部が形成される。

9.請求の範囲8に記載の気化器において、

前記気化室と前記ガス通路部を連通させる開口部が、前記遮蔽板の周囲に形成される。

10.請求の範囲8に記載の気化器において、

前記気化室と前記ガス通路部を連通させる開口部が、前記遮蔽板自体に形成される。

11. 請求の範囲10に記載の気化器において、

前記開口部は、前記遮蔽板の厚さ方向に屈折した形状を有するスリットを具備する。

12. 請求の範囲6に記載の気化器において、

前記フィルタ部材または前記遮蔽板の温度に基づいて前記加熱部の温度制御を行う制御部材を更に具備する。

13. 請求の範囲12に記載の気化器において、

前記フィルタ部材または前記遮蔽板の温度は、前記加熱部の温度と実質的に同一に設定される。

14.請求の範囲12に記載の気化器において、

前記遮蔽板に配設された温度センサを更に具備し、前記制御部材は、前記センサによる検出信号に基づいて前記加熱部の温度制御を行う。

15.請求の範囲6に記載の気化器において、

前記遮蔽板に組み込まれたヒータを更に具備する。

16. 請求の範囲6に記載の気化器において、

前記加熱部は、前記気化室の壁面内に埋め込まれたヒータを具備する。

17. 気化器であって、

液体原料を気化させて気体原料を形成する気化室と、

前記気化室に前記液体原料を噴霧する噴霧部と、

前記気化室からガス出口へ前記気体原料を送出する送出部と、

前記気化器を加熱する加熱部と、

を具備し、前記送出部は、

流通開口部を確保した状態で前記ガス出口及びその周囲の壁面を間隔をおいて被覆する板部材と、前記板部材と前記壁面との間に、前記気化室と前記ガス出口とを接続するガス通

路部が形成されることと、

前記ガス通路部内に配設された流体バッフルとして機能する複数の柱と、

前記ガス通路部を流れる前記気体原料を加熱するヒータと、を具備する。

18.請求の範囲17に記載の気化器において、

前記ヒータは前記板部材内に埋設される。

19. 請求の範囲18に記載の気化器において、

前記気化室に面する前記板部材の表面は、前記液体原料を気化させる気化面を提供する。

20.請求の範囲17に記載の気化器において、

前記ヒータの熱を前記板部材に伝達する伝熱部材を更に具備し、前記伝熱部材は前記板部材の外縁部以外の部位に熱接触する。

21.請求の範囲20に記載の気化器において、

前記複数の柱は前記伝熱部材としても機能する。

22. 請求の範囲17に記載の気化器において、

前記板部材の温度に基づいて前記加熱部の温度制御を行う温度制御部を更に具備する。

23. 請求の範囲17に記載の気化器において、

前記ガス出口と前記板部材との間で、前記気体原料を通過させるように前記ガス出口を覆うフィルタ部材を更に具備する。

24. 気化器であって、

液体原料を気化させて気体原料を形成する気化室と、

前記気化室に前記液体原料を噴霧する噴霧部と、

前記気化室からガス出口へ前記気体原料を送出する送出部と、

前記気化器を加熱する加熱部と、

を具備し、前記送出部は、

前記気体原料を通過させるように前記ガス出口を覆うフィルタ部材と、

前記加熱部の熱を前記フィルタ部材に伝達する伝熱部材と、前記ガス出口と反対側で前記フィルタ部材を被覆する遮蔽板と、

を具備する。

2 5. 被処理基板に対して半導体処理を施す装置であって、 前記被処理基板を収容する処理室と、

前記処理室内に処理ガスを供給するためのガス供給系と、を具備し、前記ガス供給系は、請求の範囲1に記載の気化器を具備する。

26. 被処理基板に対して半導体処理を施す装置であって、 前記被処理基板を収容する処理室と、

前記処理室内に処理ガスを供給するためのガス供給系と、を具備し、前記ガス供給系は、請求の範囲6に記載の気化器を具備する。

27.被処理基板に対して半導体処理を施す装置であって、 前記被処理基板を収容する処理室と、

前記処理室内に処理ガスを供給するためのガス供給系と、を具備し、前記ガス供給系は、請求の範囲17に記載の気化

器を具備する。

28. 被処理基板に対して半導体処理を施す装置であって、前記被処理基板を収容する処理室と、

前記処理室内に処理ガスを供給するためのガス供給系と、 を具備し、前記ガス供給系は、請求の範囲 2 4 に記載の気化 器を具備する。

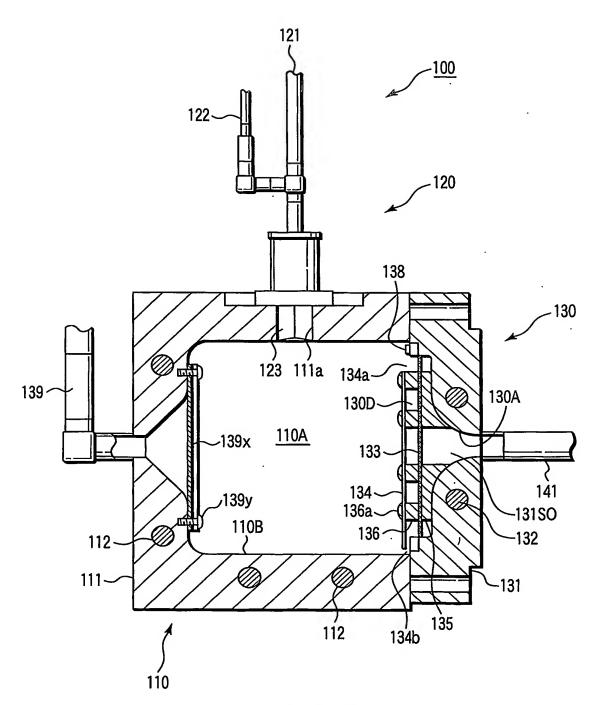


FIG.1

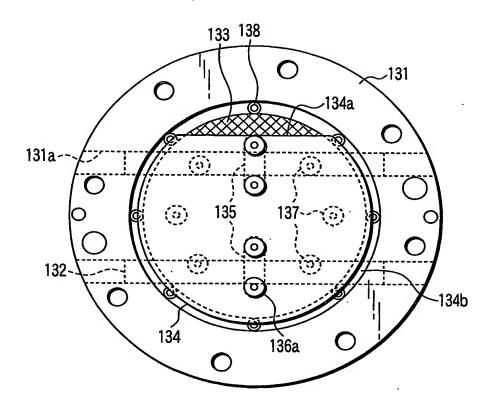
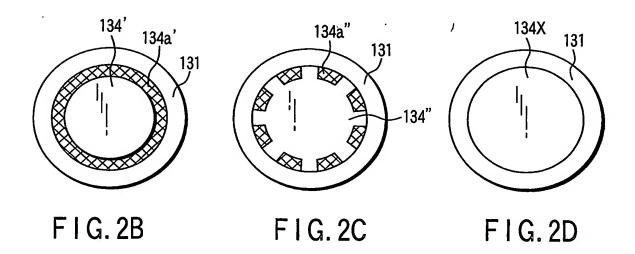
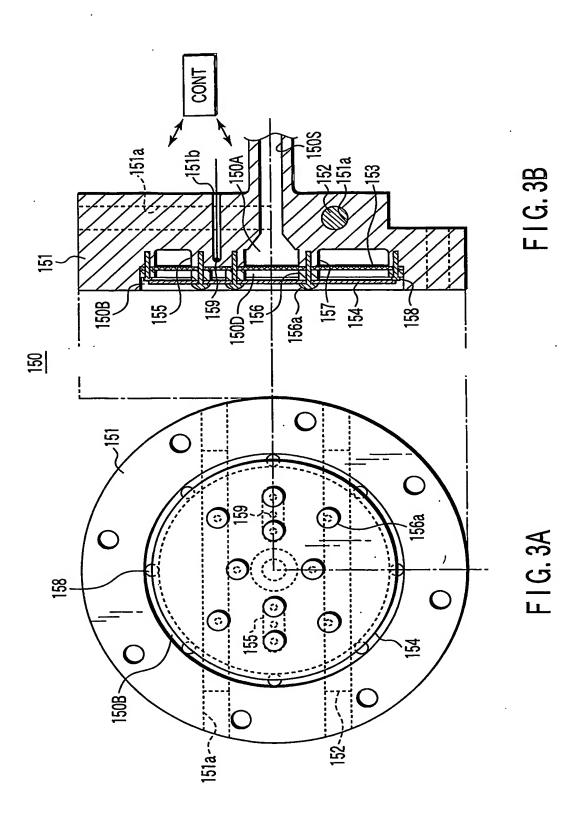
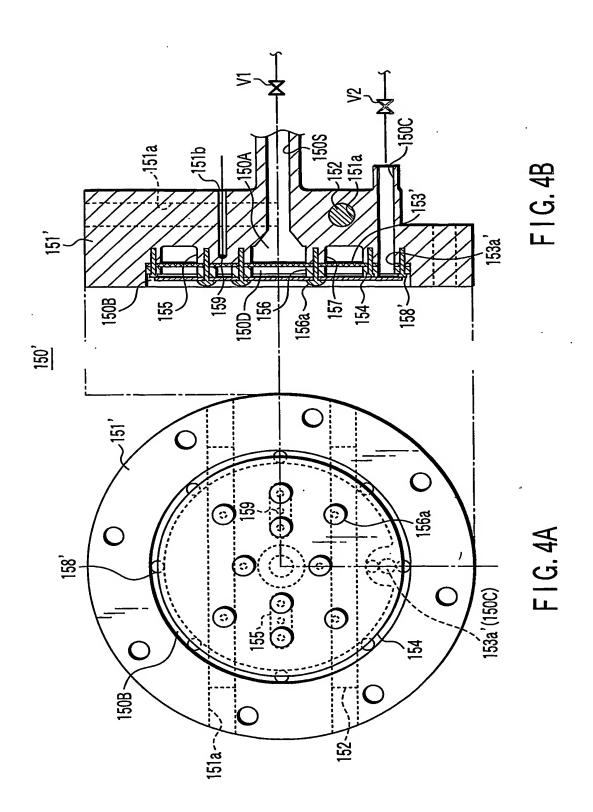
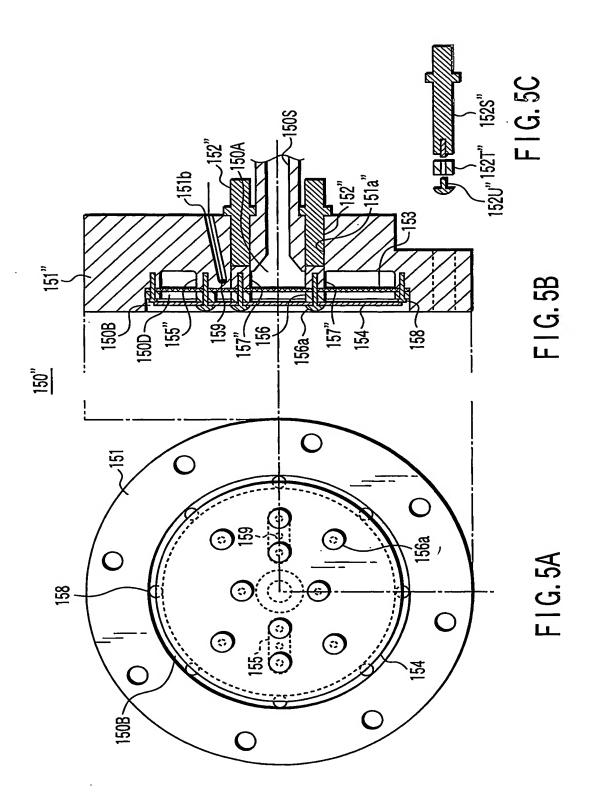


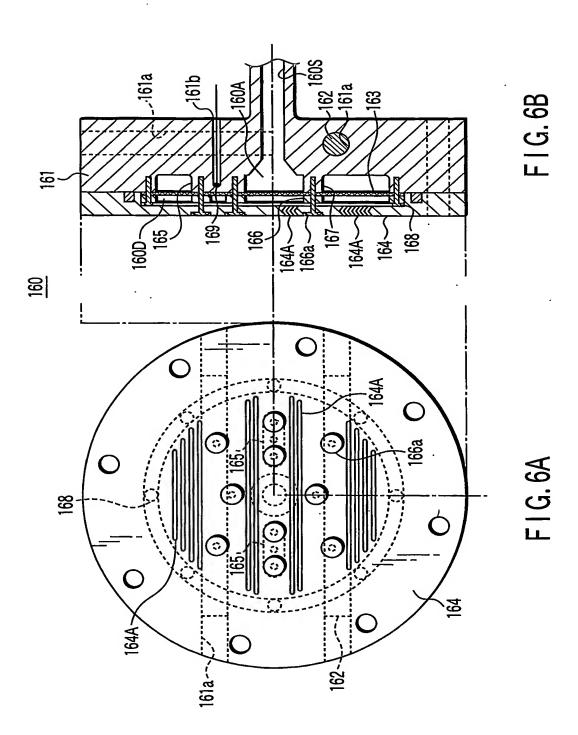
FIG. 2A

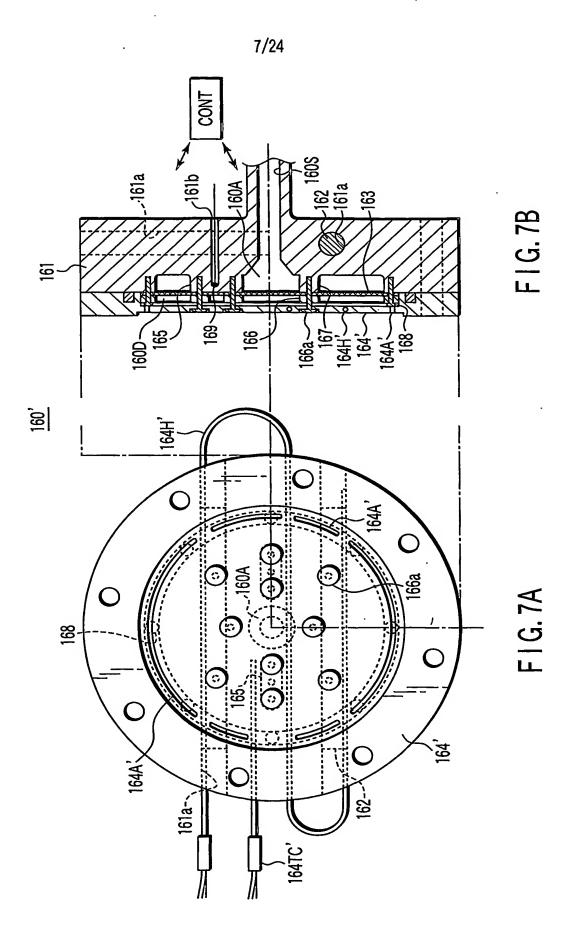


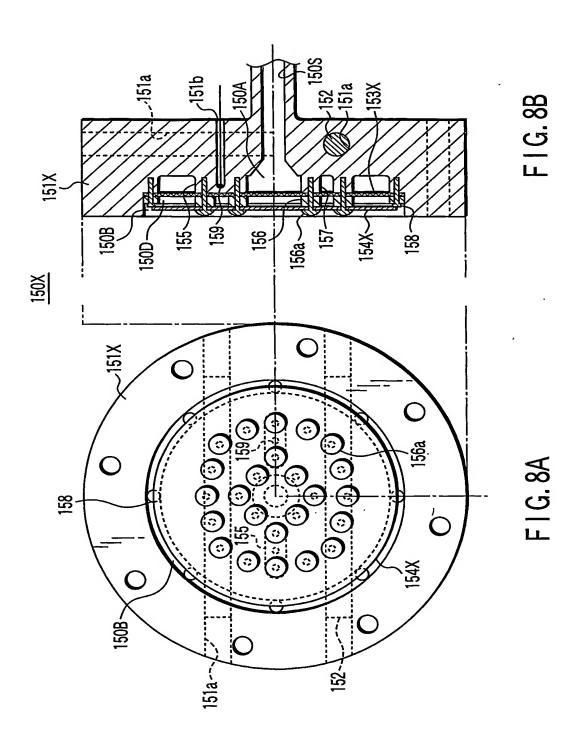


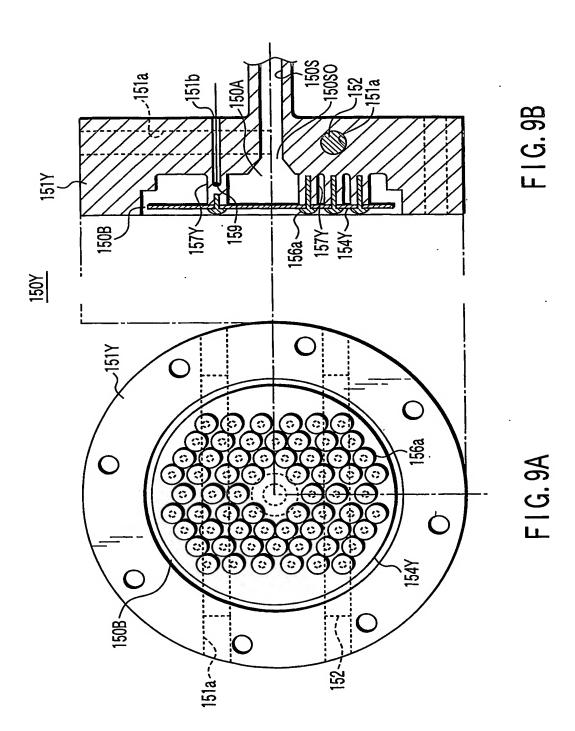


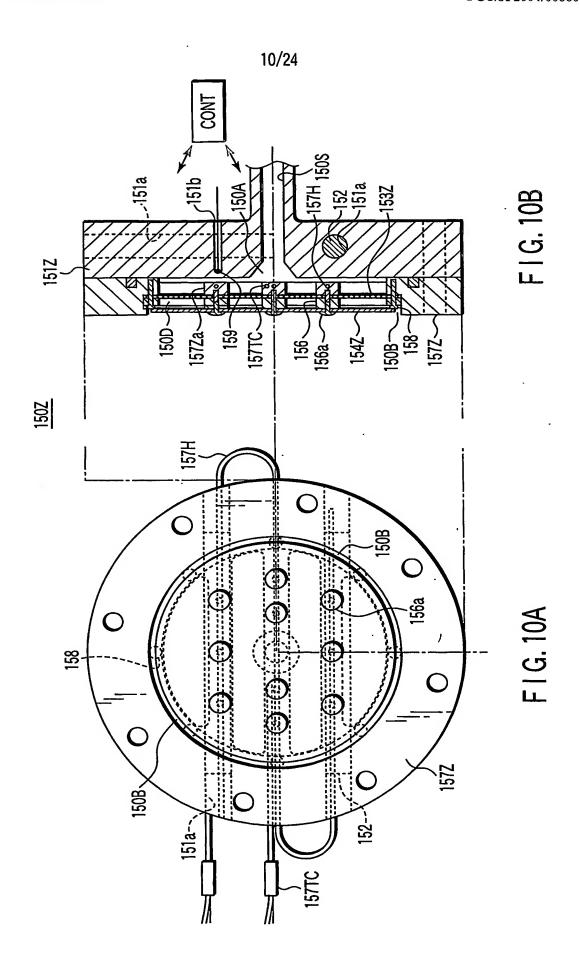


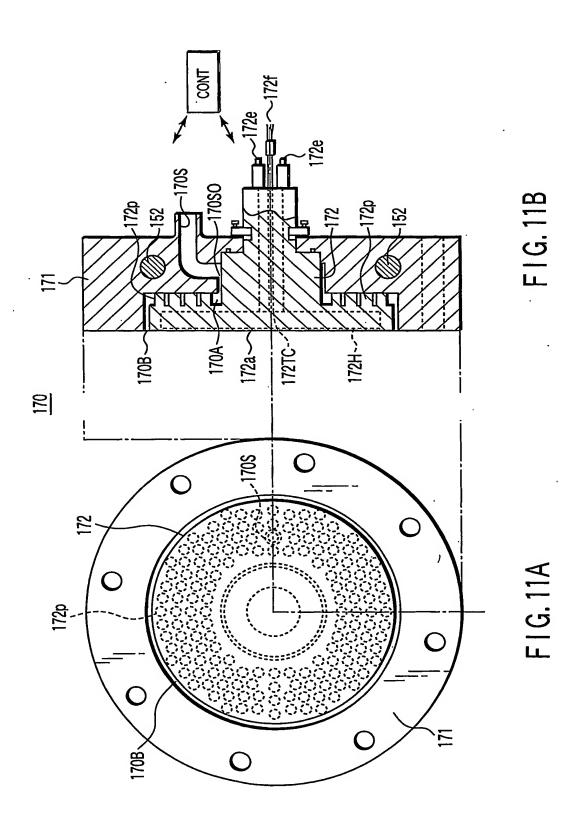




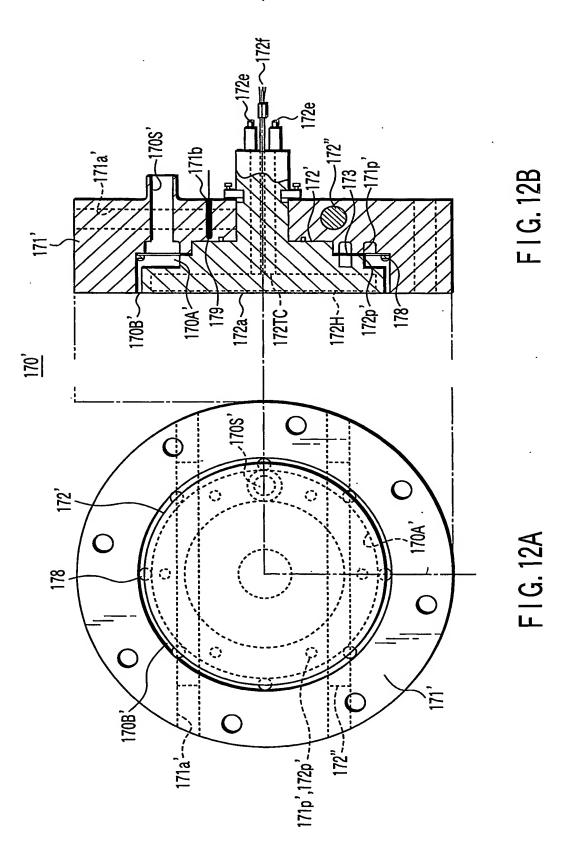


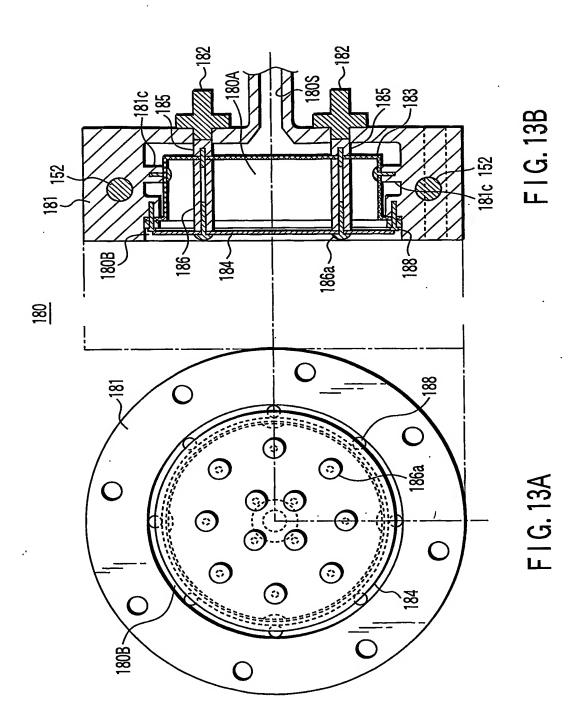




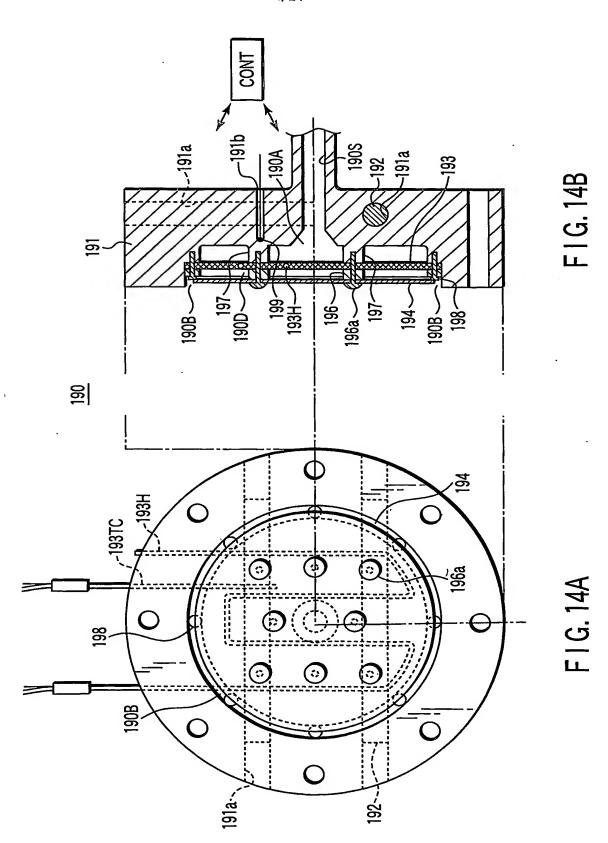


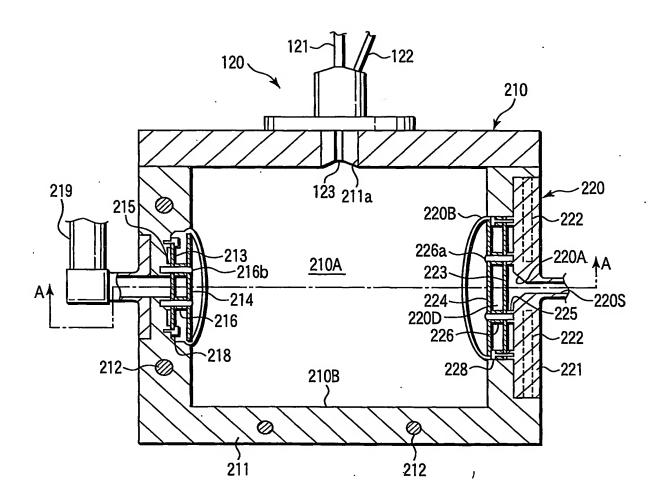












F I G. 15

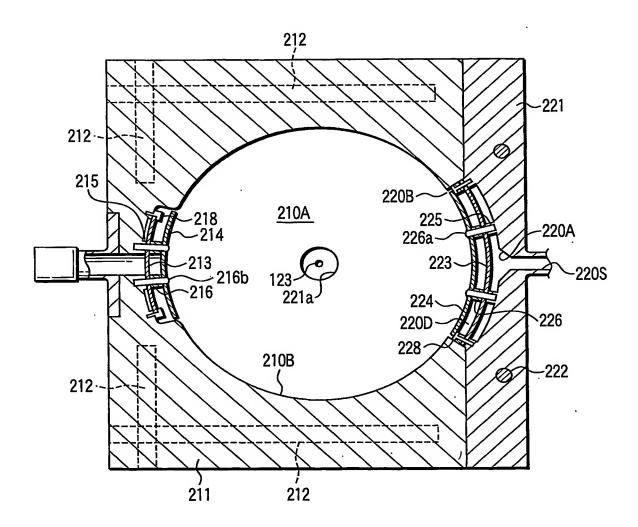
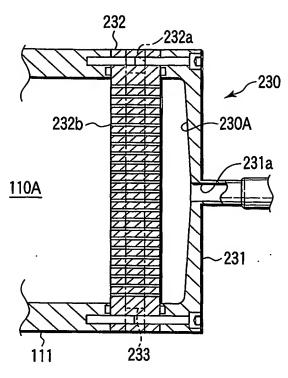


FIG. 16





F I G. 17A

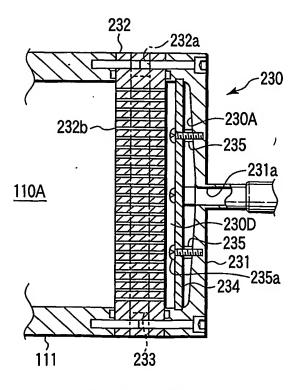


FIG. 17B

WO 2004/100249 PCT/JP2004/006609

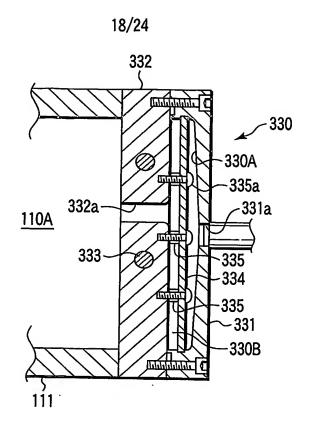


FIG. 18A

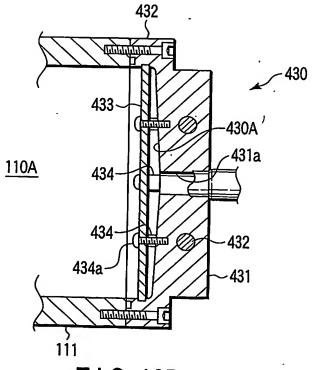


FIG. 18B

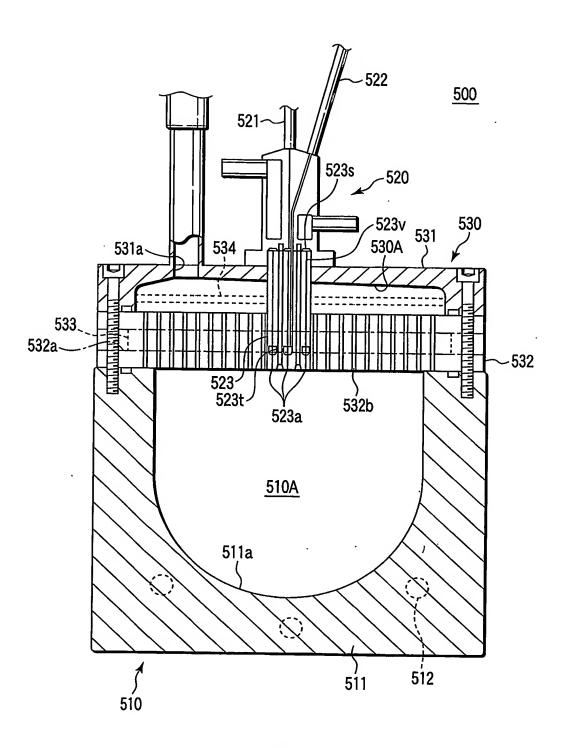
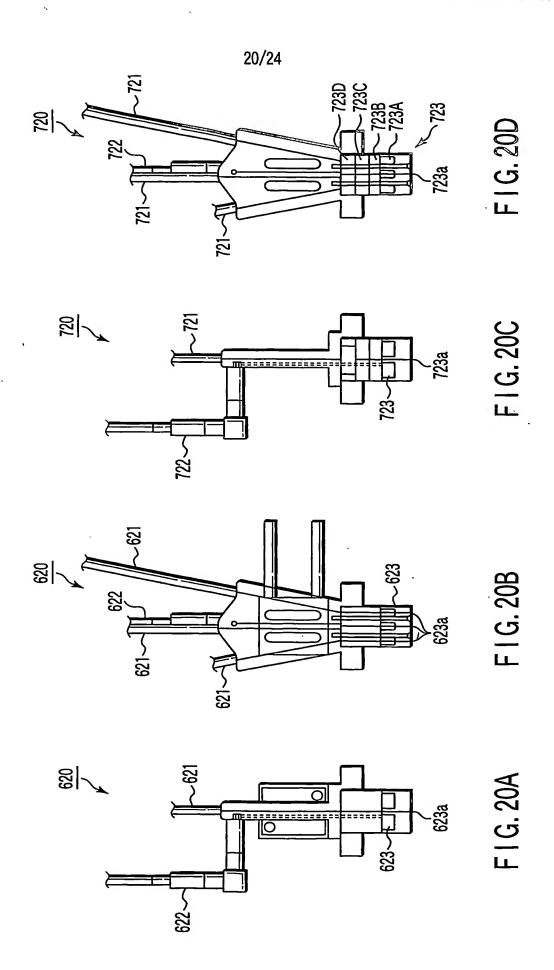


FIG. 19



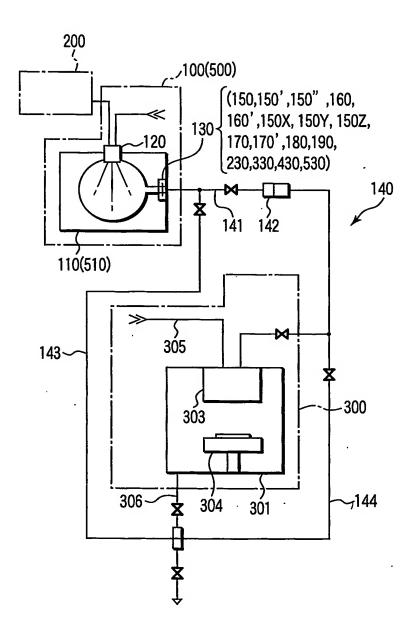
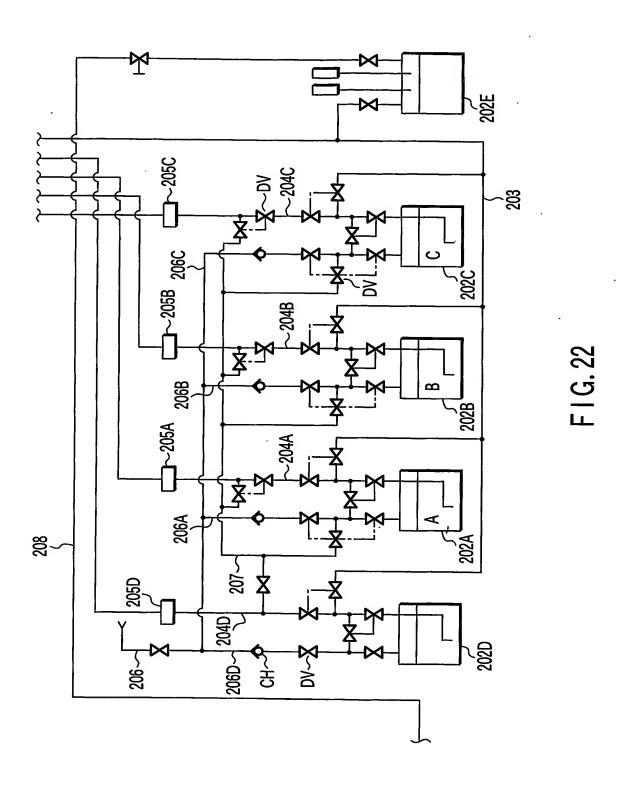
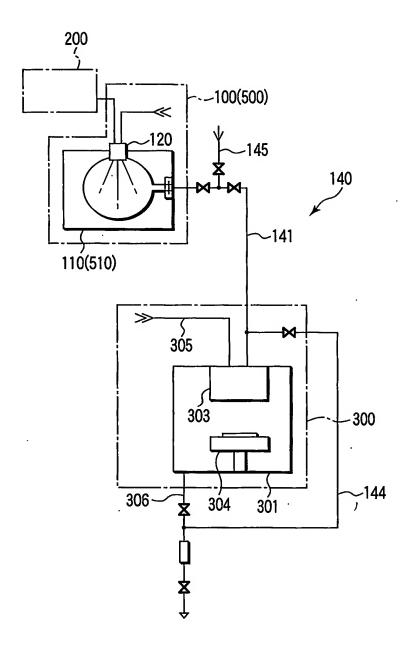
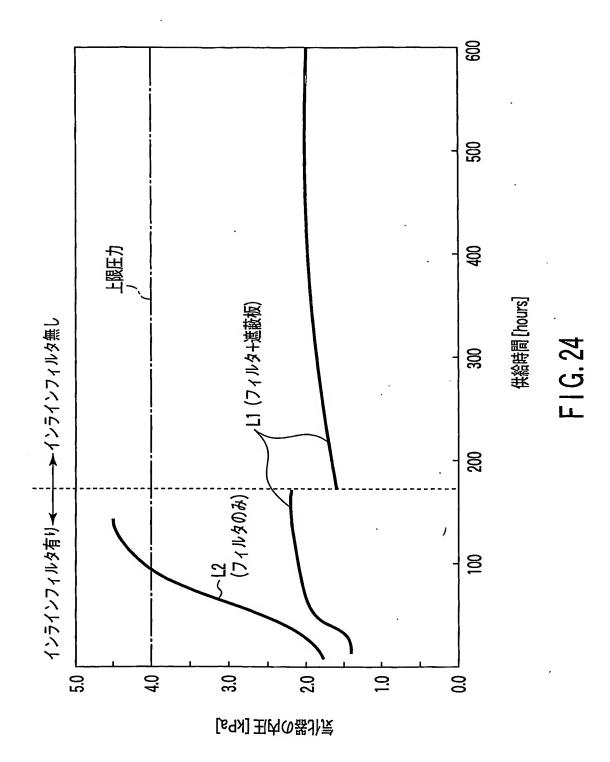


FIG. 21





F I G. 23



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

A CLASCIETO	ATTION OF BY THE TOTAL CO.		PCT/JP2004/006609
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> H01L21/31, C23C16/448			
1			
·			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS SEA	ARCHED	<del></del>	
Minimum docur	nentation searched (classification system followed by c	lassification symbols)	
Int.Cl	H01L21/31, C23C16/448, H01L2	21/205	
j			
Documentation s	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
J	T922-1996 16	oroku Jitsuyo Shinan	Koho 1994-2004
3		itsuyo Shinan Toroku	
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of	data base and, where practical	le, search terms used)
			,
C. DOCUMEN	IS CONSIDERED TO BE RELEVANT	<del></del>	
Category*	Citation of document with indication where		
E,X	Citation of document, with indication, where ap		ages Relevant to claim No.
15, 5	JP 2004-211183 A (Shimadzu ( 29 July, 2004 (29.07.04),	Corp.),	1-5,25,
E,A	Figs. 2, 5b, 6, 7; Claims 1 t	O 3. Dar Nog	6-8,12-16,26
	[0005], [0012], [0015], [0024	1) to [0034]	$\frac{9-11,17-23}{24,27,29}$
ľ	(Family: none)	-, (0001)	24,27,28
A	TD 7 04406 7 /7		
A	JP 7-94426 A (Ryoden Semicor Engineering),	iductor System	1-28
	07 April, 1995 (07.04.95),		1
	Fig. 1; Par. No. [0031]		İ
	(Family: none)		
A	TD		]
A	JP 7-310185 A (Hitachi, Ltd.	.),	1-28
	28 November, 1995 (28.11.95), Fig. 1; Par. No. [0028]		}
	(Family: none)		Í
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		<del></del>	
	ments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex	х.
	ories of cited documents:	"T" later document published	after the international filing date or priority
	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention		
"E" carlier applie	arrier application or patent but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be		
	ning date considered novel or cannot be considered to involve an inventive		
cited to esta	cited to establish the publication date of another citation or other		
	n (as specified)  Cerring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an	I inventive step when the document is
"P" document pu	blished prior to the international filing date but later than	being obvious to a person	e other such documents, such combination skilled in the art
the priority date claimed "&" document member of the same patent family			
Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report			
Date of the actual completion of the international search  12 August, 2004 (12.08.04)  Date of mailing of the international search report  31 August, 2004 (31.08.04)			
31 August, 2004 (31.08.04)			
Name and mailing address of the ISA/			
Japanes	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office  Authorized officer		
Pacsimile No.  Telephone No.			
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)			

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

(Cantilla )	A DOCUMENT CONCERN TO THE	PCT/JP2	004/006609
	). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<b>~</b>
Category*			Relevant to claim No
A	JP 2000-119858 A (Mitsubishi Materials C 25 April, 2000 (25.04.00), Par. No. [0006] (Family: none)	orp.),	1-28
A	JP 8-131812 A (Nippon Tairan Kabushiki K 28 May, 1996 (28.05.96), Par. No. [0021]; Fig. 3 (Family: none)	aisha),	17-24,27,28
А	JP 6-310444 A (Ryoden Semiconductor Systematic Engineering), 04 November, 1994 (04.11.94), Figs. 13, 14 (Family: none)	em	1-28
			•

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/006609

Box No.	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
This inte	emational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
I. [_]	Claims Nos.:
	because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. 🗀	Obstruct
	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
<u> </u>	and third sentences of Rule 6.4(a).
Box No.	Continuation of item 3 of first sheet)
a var for . units speci Conse follo 1. 2.	mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:  technical feature common to claims 1-28 is "a vaporizer comprising porizing chamber for vaporizing a liquid material, a spraying unit, a delivery unit for conveying the gaseous material, and heating s for". This common technical feature, however, cannot be "a ial technical feature", since such a constitution is publicly known. equently, the international application is considered to contain the owing three groups of inventions.  Claims 1-5, 24, 25, 28  Claims 6-16, 26  Claims 17-23, 27
1 A	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of
"	any additional fee.
3	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. N	To required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is estricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark or	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
	No protest accompanied the payment of additional search fees.

### 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L21/31, C23C16/448

#### 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' H01L21/31, C23C16/448, H01L21/205

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

			<del> </del>
	<u>C.</u> 関連する	ると認められる文献	
	引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	E, X	JP 2004-211183 A (株式会社 島津製作所), 2004.07.29, 図2, 図5b, 図6, 図7, 請求項1-3, 段落番号【0005】,【0012】,【0015】,【0024】-【0034】	1-5, 25 6-8, 12-16, 26
	<u>E, A</u>	(ファミリーなし)	9-11, 17-23, 24, 27, 28
	A 	JP 7-94426 A (菱電セミコンダクタシステムエンジニアリング株式会社),1995.04.07,図1、段落番号【0031】(ファミリーなし)	1-28
- [			

### 🛛 C欄の続きにも文献が列挙されている。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

12.08.2004

国際調査報告の発送日

31. 8. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 藤原 敬士

4 R 8406

電話番号 03-3581-1101 内線 3469

·	Bish Digital To 1/ J f Z U C	0 47 0 0 0 0 0 3
C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	には、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これ	関連する 請求の範囲の番号
A .	JP 7-310185 A (株式会社日立製作所),1995.11.28, 図1,段落番号【0028】(ファミリーなし)	1-28
A	JP 2000-119858 A (三菱マテリアル株式会社), 2000.04.25, 段落番号【0006】 (ファミリーなし)	1 - 2 8
A	JP 8-131812 A (日本タイラン株式会社), 1996.05.28, 段落番号【0021】, 図3 (ファミリーなし)	17-24, 27, 28
A	JP 6-310444 A (菱電セミコンダクタシステムエンジニアリング株式会社), 1994.11.04, 図13, 図14 (ファミリーなし)	1-28
		,
		·
		·

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
法第8条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. □ 請求の範囲 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
·
2.   請求の範囲 は、有意識な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい
2. [_] 請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. □ 請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
請求の範囲 $1-28$ において共通する技術的特徴は、「気化器であって、液体原料を気化させて〜気化室と、〜噴霧部と、〜気体原料を送出する送出部と、〜加熱部と、を具備し」た気化器であるが、当該構成は、周知のものであり、当該共通する技術的特徴を持って「特別な技術的特徴」とは認められず、それぞれ下記の $3$ つの発明群からなっているものである。
1. 請求の範囲1-5, 24, 25, 28 2. 請求の範囲6-16, 26 3. 請求の範囲17-23, 27
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. X 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3.
4.
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意
□ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。